

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-195507

(43)Date of publication of application : 09.07.2003

(51)Int.CI.

G03F 7/039
C08F232/04
G03F 7/004
H01L 21/027

(21)Application number : 2001-399235

(71)Applicant : JSR CORP

(22)Date of filing : 28.12.2001

(72)Inventor : NISHIMURA YUKIO
ISHII HIROYUKI
SANO KIMIYASU
KOBAYASHI HIDEKAZU

(54) RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation-sensitive resin composition having high transparency for radiation, excellent basic performances as a resist such as sensitivity, resolution, dry etching durability, pattern profile, and suitable as a chemical amplification type resist having high resolution property in a fine pattern region.

SOLUTION: The radiation-sensitive resin composition contains (A) a resin which contains a norbornene-based repeating unit derived from 5-(2-methyl-2-adamantyl)oxycarbonylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-(1-methyl-1-cyclopentyl)oxycarbonylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene or the like and a (meth)acrylate-based repeating unit derived from 3-hydroxy-1-adamantyl(meth)acrylate, 1-methyl-1-cyclohexyl(meth)acrylate or the like and which is converted into alkali-soluble by the effect of an acid, and (B) a radiation-sensitive acid generator.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPS)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-195507

(P2003-195507A)

(43)公開日 平成15年7月9日(2003.7.9)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
G 03 F 7/039	6 0 1	G 03 F 7/039	6 0 1 2 H 0 2 5
C 08 F 232/04		C 08 F 232/04	4 J 1 0 0
G 03 F 7/004	5 0 1	G 03 F 7/004	5 0 1
	5 0 3		5 0 3 A
H 01 L 21/027		H 01 L 21/30	5 0 2 R
		審査請求 未請求 請求項の数 8	OL (全 33 頁)

(21)出願番号 特願2001-399235(P2001-399235)

(22)出願日 平成13年12月28日(2001.12.28)

(71)出願人 000004178

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 西村 幸生

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
エスアール株式会社内

(72)発明者 石井 寛之

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
エスアール株式会社内

(74)代理人 100100985

弁理士 福沢 俊明

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

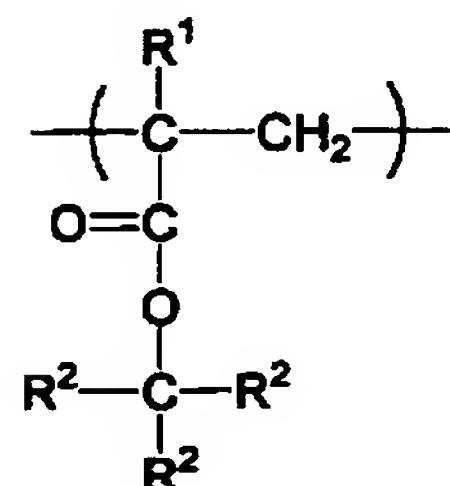
【課題】 放射線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッティング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本性能に優れるとともに、微細パターン領域での高い現像性を有する化学増幅型レジストとして好適な感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A) 5-(2-メチル-2-アダマンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-(1-メチル-1-シクロベンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン等に由来するノルボルネン系繰り返し単位と、3-ヒドロキシ-1-アダマンチル(メタ)アクリレート、1-メチル-1-シクロヘキシル(メタ)アクリレート等に由来する(メタ)アクリル酸系繰り返し単位とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有する。

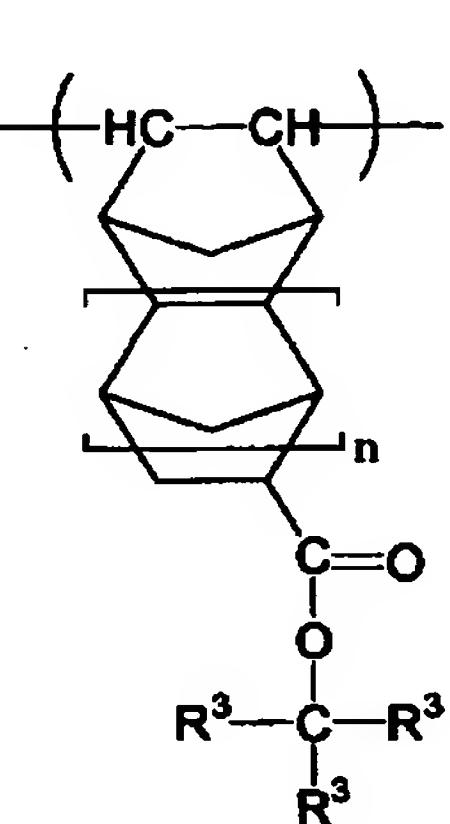
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) 下記一般式(1-1)で表される繰返し単位および下記一般式(1-2)で表される繰り返し単位を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに
(B) 感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

[化1]



(1-1)



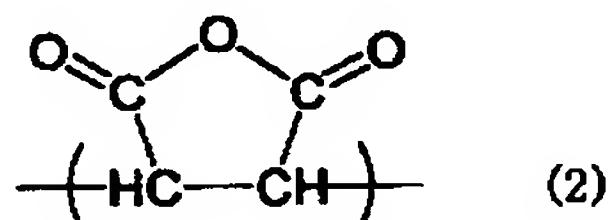
(1-2)

[一般式(1-1)において、R¹は水素原子またはメチル基を示し、各R²は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つR²の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR²が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR²が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体である。一般式(1-2)において、各R³は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示す。]

* 体、または炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つR³の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR³が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR³が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であり、nは0～2の整数である。】

10 【請求項2】 (A) 請求項1記載の一般式(1-1)で表される繰り返し単位および請求項1記載の一般式(1-2)で表される繰り返し単位と、下記一般式(2)で表される繰り返し単位とを有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、および(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

〔化2〕

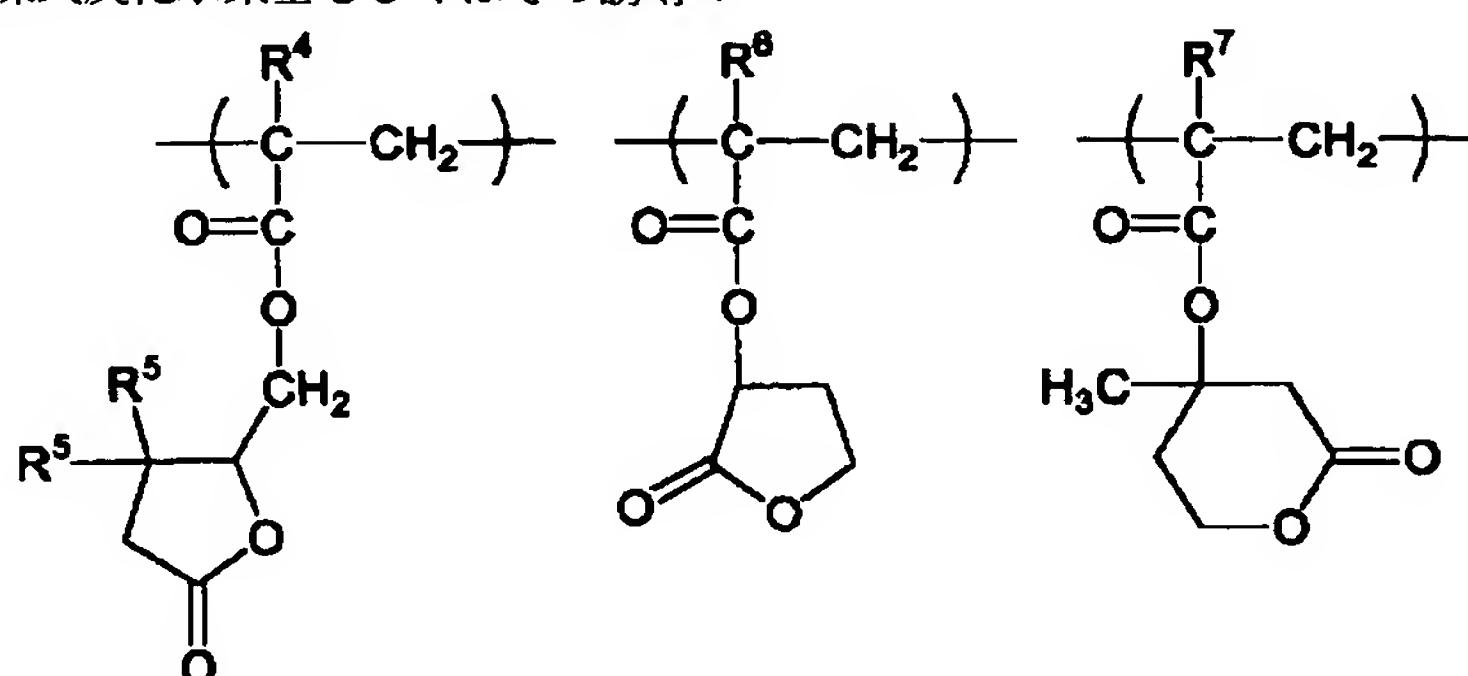


【請求項3】 (A) 成分の樹脂における一般式(1-1)で表される繰り返し単位の一般式(1-2)で表される繰り返し単位に対するモル比が0.5~2である請求項1または請求項2に記載の感放射線性樹脂組成物

【請求項4】 (A) 成分の樹脂において、一般式(1-2)中の基-C(R³)₂が2-メチル-2-アダマンチル基あるいは2-エチル-2-アダマンチル基である請求項1～3の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

30 【請求項5】 (A) 成分の樹脂がさらに下記一般式(3-1)、一般式(3-2)、一般式(3-3)、一般式(3-4)または一般式(3-5)で表される繰り返し単位の少なくとも1種を有する請求項1～4の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

[113]

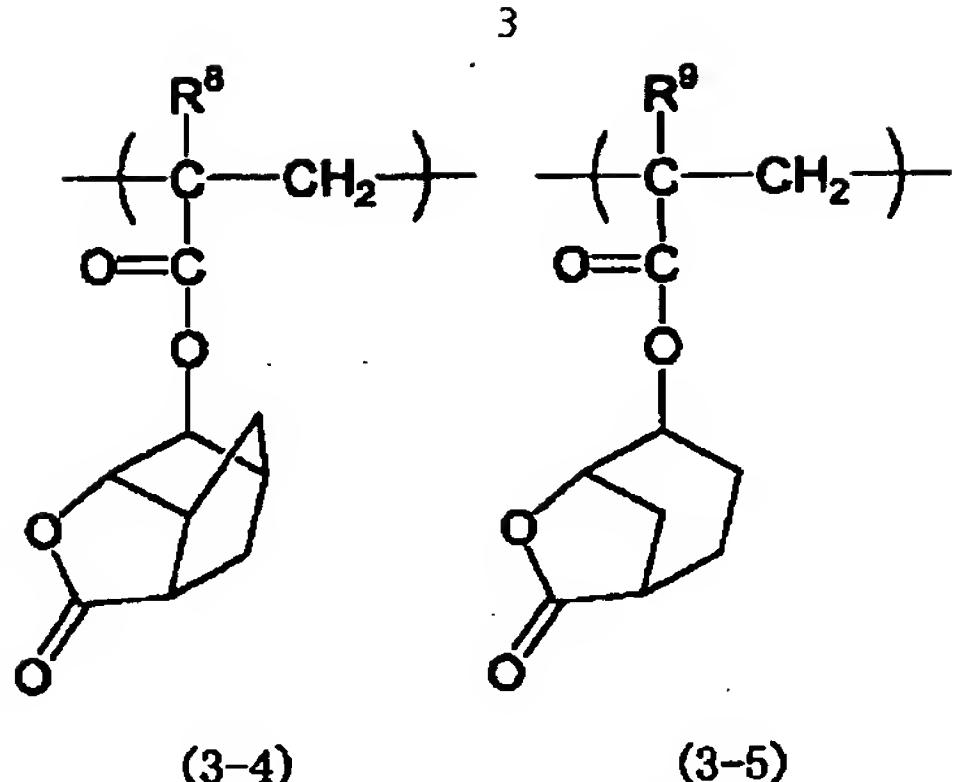


(3-1)

(3-2)

(3-3)

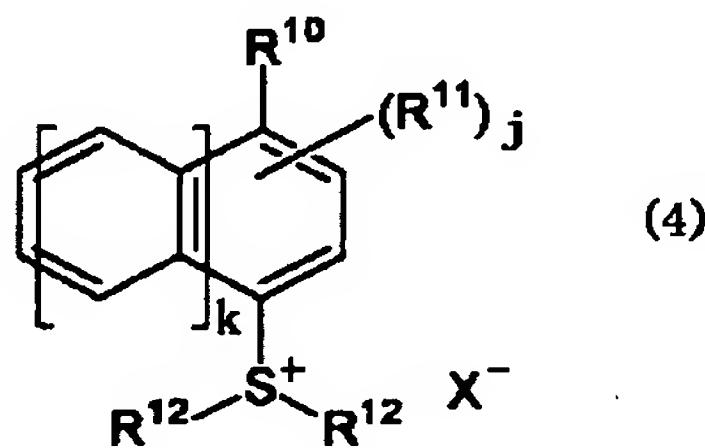
[154]



〔一般式(3-1)～(3-5)において、R¹、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸およびR⁹は相互に独立に水素原子またはメチル基を示す。〕

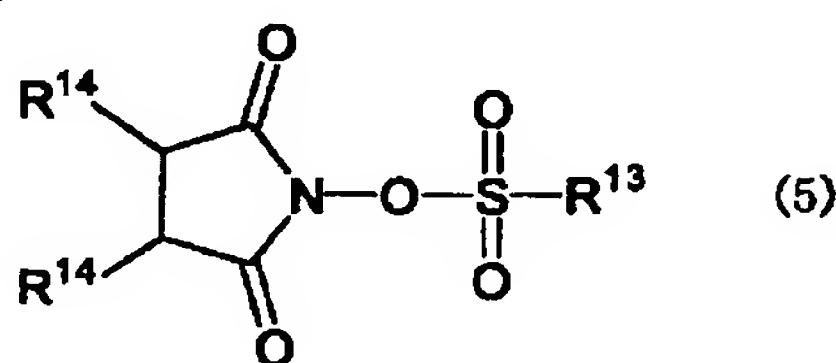
【請求項6】 (B) 成分の感放射線性酸発生剤が下記一般式(4)で表されるイオン性化合物と下記一般式(5)で表される非イオン性化合物との混合物を含む請求項1～5の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

[化5]



(一般式(4)において、 R^{10} は水素原子、水酸基、炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシリル基、炭素数2～11の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニル基を示し、 R^{11} は水素原子または炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、 j は0～3の整数であり、各 R^{12} は相互に独立に炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換されていてもよいフェニル基または置換基されていてもよいナフチル基を示すか、あるいは2つの R^{12} が互いに結合して炭素数2～10の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよく、 k は0～2の整数であり、 X^- は $C_a F_{2a+1} SO_3^-$ の構造を有するアニオンを示し、 a は1～10の整数である。)

[1E6]

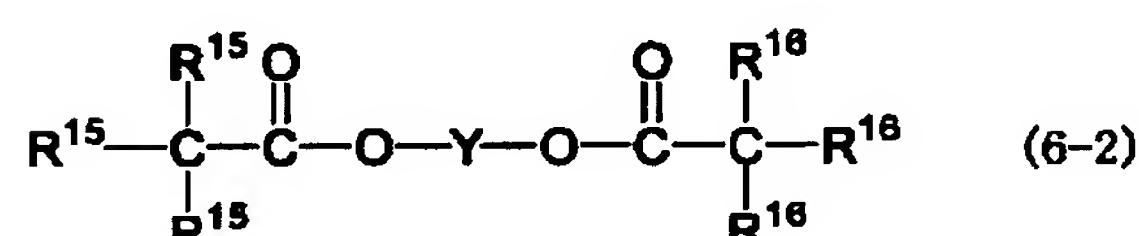
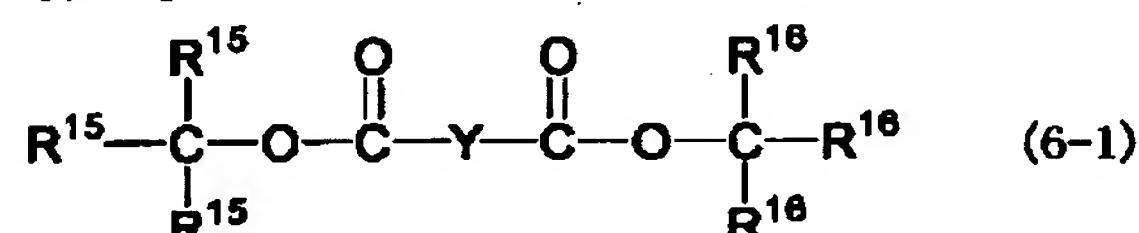


(一般式(5)において、 R^{13} は $C_b F_{2b+1}$ 一基を示し、 b は1～10の整数であり、各 R^{14} は相互に独立に水素原子または炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状

4 のアルキル基を示すか、あるいは2つのR¹⁴が互いに結合して炭素数2～20の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよい。」

【請求項7】 さらに(C)下記一般式(6-1)または一般式(6-2)で表される分子量1,000以下の化合物を含有することを特徴とする請求項1~6の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

〔化7〕



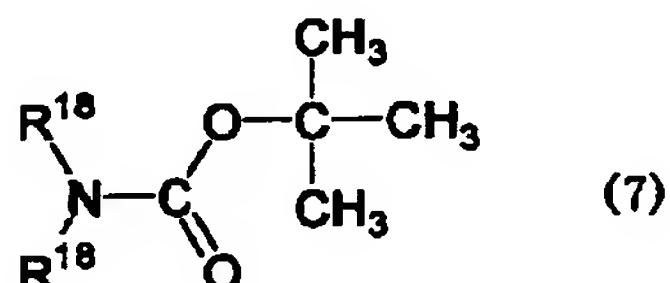
(一般式(6-1)および一般式(6-2)において、各Yは相互に独立に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1～15の直鎖状もしくは分岐状の2価の炭化水素基を示し、各R¹⁵は相互に独立に炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、水素原子または炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR¹⁵の少なくとも1つが炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または-CH₂-R¹⁷基(但し、R¹⁷は炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示す。)であるか、あるいは何れか2つのR¹⁵が相互の結合して、それそれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR¹⁵が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは3つのR¹⁵が相互の結合して、それそれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成しており、各R¹⁶は相互に独立に炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、水素原子または炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR¹⁶の少なくとも1つが炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または-CH₂-R¹⁷基

(但し、 R^{17} は炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示す。)であるか、あるいは何れか2つの R^{16} が相互の結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りの R^{16} が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは3つの R^{16} が相互の結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の1価

の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成している。】

【請求項8】 さらに(D)下記一般式(7)で表される化合物を含有することを特徴とする請求項1~7の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

【化8】



【一般式(7)において、各R¹⁸は相互に独立に炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数6~20の1価の脂環族基を示すか、あるいは2つのR¹⁸が相互に結合して炭素数2~20の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよい。】

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、KrFエキシマレーザーあるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学增幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物に関わる。

【0002】

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近では0.20μm以下のレベルでの微細加工が可能なリソグラフィー技術が必要とされている。従来のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブクオーターミクロノーメトリックレベルの微細加工が極めて困難であると言われている。そこで、0.20μm以下のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利用が検討されている。このような短波長の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げることができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレーザー(波長248nm)あるいはArFエキシマレーザー(波長193nm)が注目されている。このようなエキシマレーザーによる照射に適したレジストとして、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射(以下、「露光」という。)により酸を発生する成分(以下、「酸発生剤」という。)とによる化学增幅効果を利用したレジスト(以下、「化学增幅型レジスト」という。)が数多く提案されている。化学增幅型レジストとしては、例えば、特公平2-27660号公報には、カルボン酸のt-ブチルエステル基またはフェノールのt-ブチルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤とを含有するレジストが提案されている。このレジストは、露光

により発生した酸の作用により、重合体中に存在するt-ブチルエステル基あるいはt-ブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものである。

【0003】ところで、従来の化学增幅型レジストの多くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線を使用すると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できないという欠点があり、そのため露光量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジストパターンが上部が細く下部にいくほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得られないなどの問題があった。その上、現像後のレジストパターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジストパターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が速くなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる問題もあった。一方、レジストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を高めることにより改善することができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表される(メタ)アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特開平4-226461号公報には、メタクリレート系樹脂を使用した化学增幅型レジストが提案されている。しかしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものとは言えない。

【0004】また、化学增幅型レジストについて、放射線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチング耐性を改善する方策の一つとして、レジスト中の樹脂成分に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られており、例えば特開平7-234511号公報には、脂肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用した化学增幅型レジストが提案されている。しかしながら、このレジストでは、樹脂成分が有する酸解離性官能基として、従来の酸により比較的解離しやすい基(例えば、テトラヒドロビラニル基等のアセタール系官能基)や酸により比較的解離し難い基(例えば、t-ブチルエステル基、t-ブチルカーボナート基等のt-ブチル系官能基)が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に

50

難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠点がある。さらに、このレジスト中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。また、化学増幅型レジストを用いてレジストパターンを形成する際には、酸解離性官能基の解離を促進するため、通常露光後に加熱処理されるが、普通、その加熱温度が変化するとレジストパターンの線幅もある程度変動するのが避けられない。しかし、近年における集積回路素子の微細化を反映して、露光後の加熱温度の変化に対しても線幅の変動（即ち温度依存性）が小さいレジストの開発も強く求められるようになってきた。

【0005】さらに、化学増幅型レジストにおいては、酸発生剤がレジストとしての機能に大きな影響を及ぼすことが知られており、今日では、露光による酸発生の量子収率が高く、高感度であるなどの理由から、オニウム塩化合物が化学増幅レジストの酸発生剤として広く使用されている。前記オニウム塩化合物としては、例えば、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホネート、シクロヘキシルメチル（2-オキソシクロヘキシル）スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等が使用されているが、これらの従来のオニウム塩化合物は、一般に感度の点で満足できず、また感度が比較的高い場合でも、解像度、パターン形状等を総合したレジスト性能の点で未だ十分とは言えない。このような状況の下、集積回路素子における微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、遠紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能で、放射線に対する透明性が高く、かつ感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた化学増幅型レジストが強く求められている。

【0006】

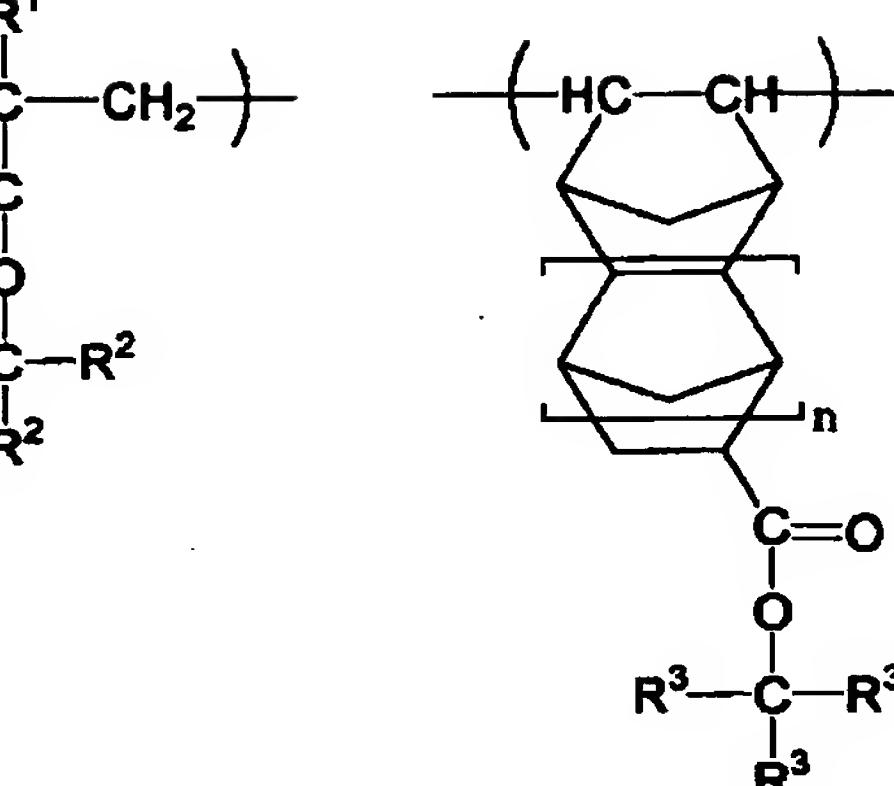
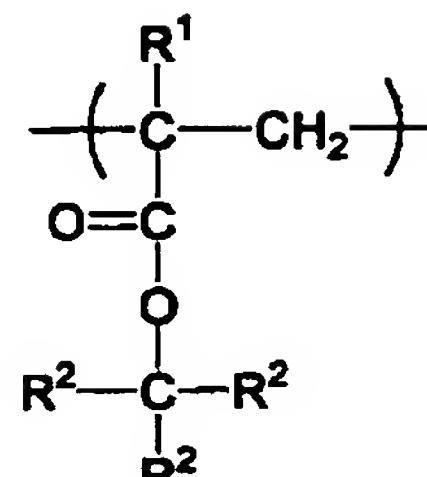
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、放射線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本性能に優れるとともに、微細パターン領域での高い現像性を有する化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、第一に、(A) 下記一般式(1-1)で表される繰り返し単位および下記一般式(1-2)で表される繰り返し単位を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに(B) 感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

【0008】

【化9】



(1-1)

(1-2)

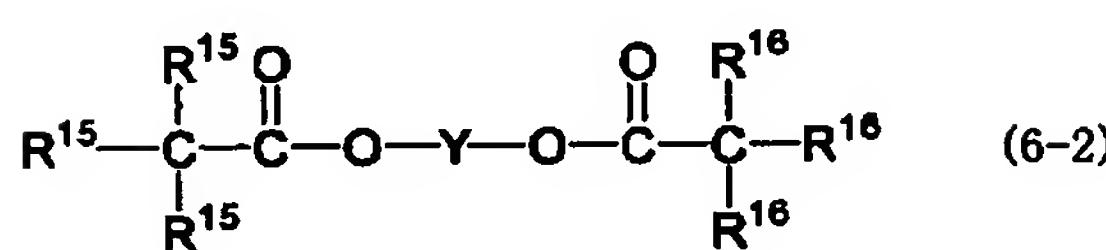
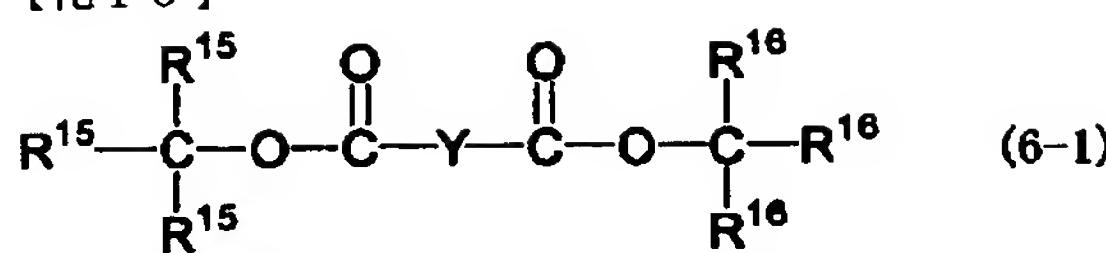
【0009】【一般式(1-1)において、R¹は水素原子またはメチル基を示し、各R²は相互に独立に炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つR²の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR²が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR²が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体である。】

【0010】一般式(1-2)において、各R³は相互に独立に炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つR³の少なくとも1つが該脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは何れか2つのR³が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR³が炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であり、nは0～2の整数である。】

【0011】本発明によると、前記課題は、第二に、(A) 前記一般式(1-1)で表される繰り返し単位および前記一般式(1-2)で表される繰り返し単位を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B) 感放射線性酸発生剤、並びに(C) 下記一般式(6-1)または一般式(6-2)で表される分子量1,000以下の化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

9

【化10】



【0013】【一般式(6-1)および一般式(6-2)において、各Yは相互に独立に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、または炭素数1~15の直鎖状もしくは分岐状の2価の炭化水素基を示し、各R¹⁵は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、水素原子または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR¹⁵の少なくとも1つが炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または-CH₂-R¹⁷基(但し、R¹⁷は炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示す。)であるか、あるいは何れか2つのR¹⁵が相互の結合して、それが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR¹⁵が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは3つのR¹⁵が相互の結合して、それが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成しており。】

【0014】各R¹⁶は相互に独立に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、水素原子または炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、かつR¹⁶の少なくとも1つが炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体または-CH₂-R¹⁷基(但し、R¹⁷は炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示す。)であるか、あるいは何れか2つのR¹⁶が相互の結合して、それが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成して、残りのR¹⁶が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であるか、あるいは3つのR¹⁶が相互の結合して、それが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成している。】

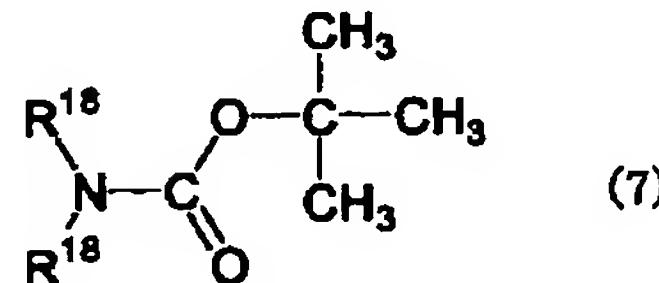
【0015】本発明によると、前記課題は、第三に、(A)前記一般式(1-1)で表される繰り返し単位および前記一般式(1-2)で表される繰り返し単位を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶

10

性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B)感放射線性酸発生剤、並び(D)前記一般式(7)で表される化合物にを含有する感放射線性樹脂組成物によって達成される。

【0016】

【化11】



【一般式(7)において、各R¹⁸は相互に独立に炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数6~20の1価の脂環族基を示すか、あるいは2つのR¹⁸が相互に結合して炭素数2~20の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよい。】

【0017】本発明によると、前記課題は、第四に、(A)前記一般式(1-1)で表される繰り返し単位および前記一般式(1-2)で表される繰り返し単位を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、(B)感放射線性酸発生剤、(C)前記一般式(6-1)または一般式(6-2)で表される分子量1,000以下の化合物、並びに(D)前記一般式(7)で表される化合物を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

【0018】以下、本発明について詳細に説明する。

(A) 成分

本発明における(A)成分は、上記一般式(1-1)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(1-1)」)および上記一般式(1-2)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(1-2)」)を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性を示すアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂(以下、「樹脂(A)」)といふ。)からなる。ここでいう「アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性」とは、樹脂(A)を含有する感放射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現像条件下で、当該レジスト被膜の代わりに樹脂(A)のみを用いた被膜を現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現像後に残存する性質を意味する。

【0019】一般式(1-1)および一般式(1-2)において、R²およびR³の炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素基、何れか2つのR¹が相互に結合して形成した炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基、並びに何れか2つのR³が相互に結合して形成した炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタンや、シクロブタン、シクロヘンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等の

11

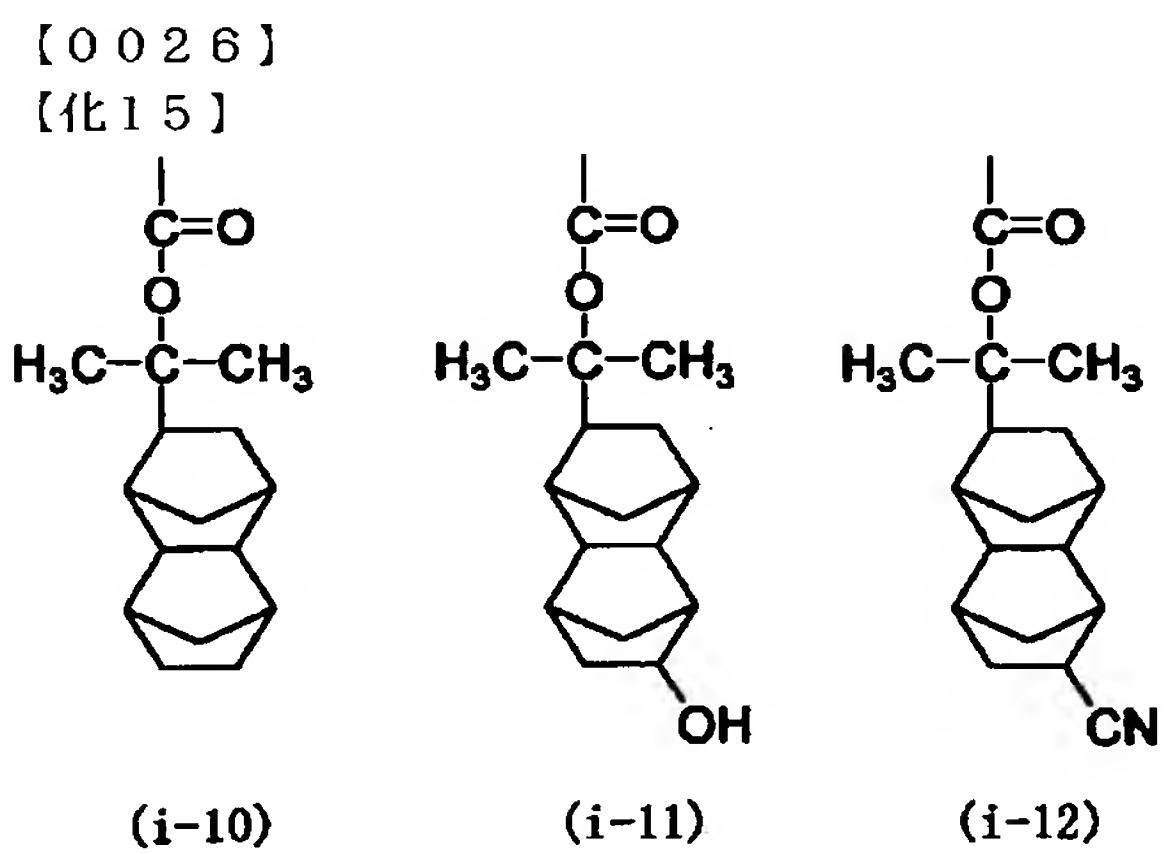
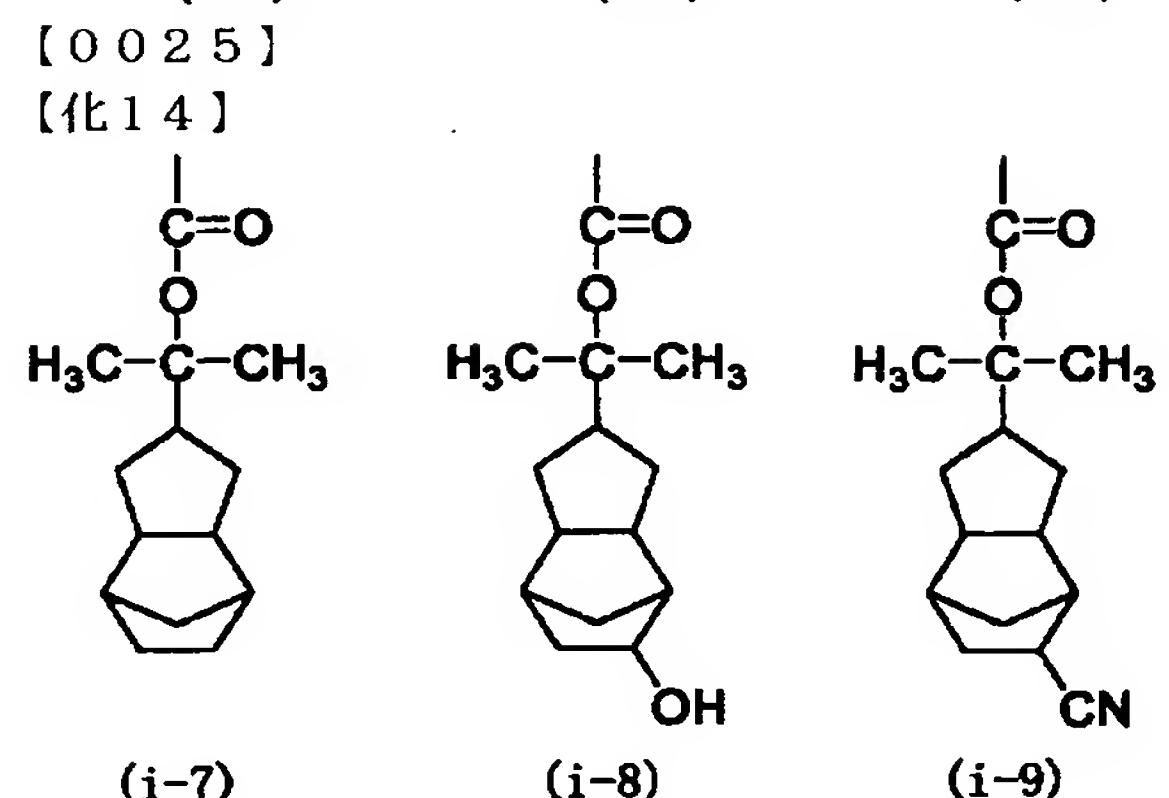
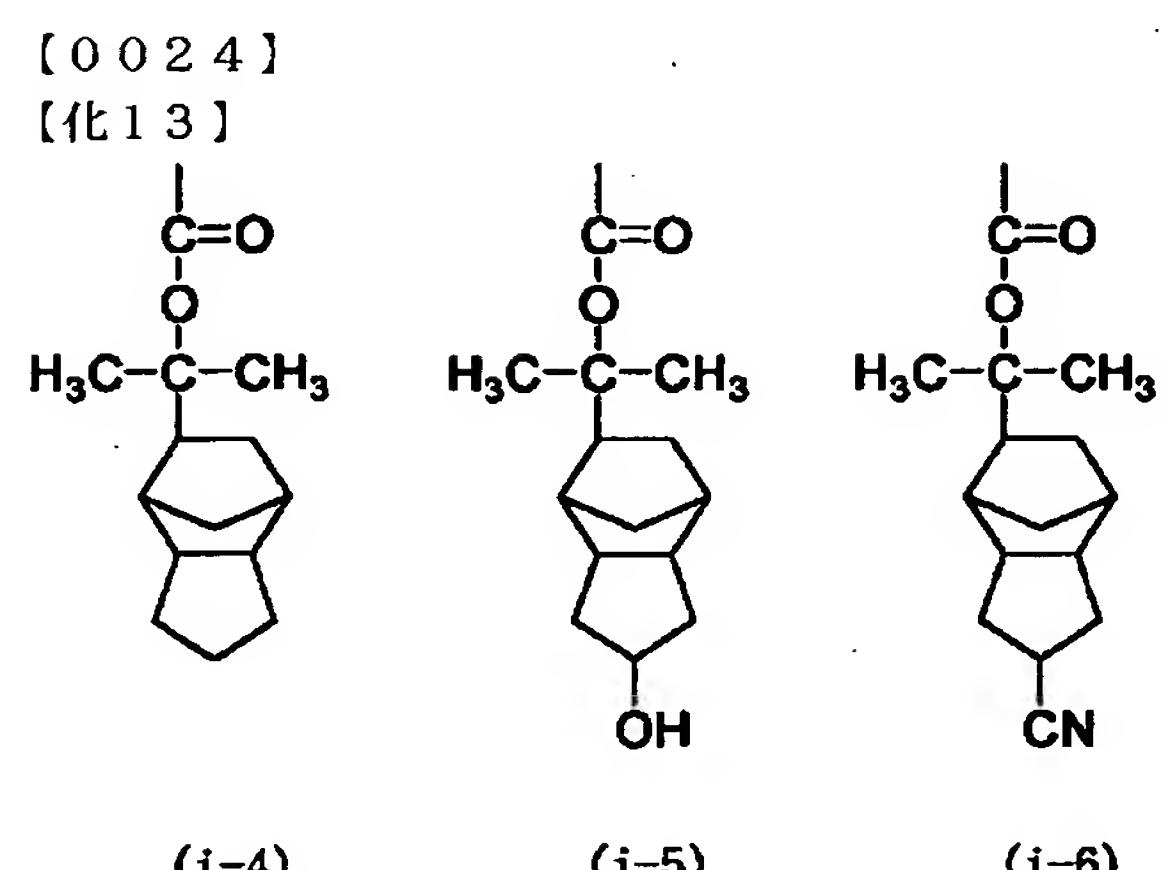
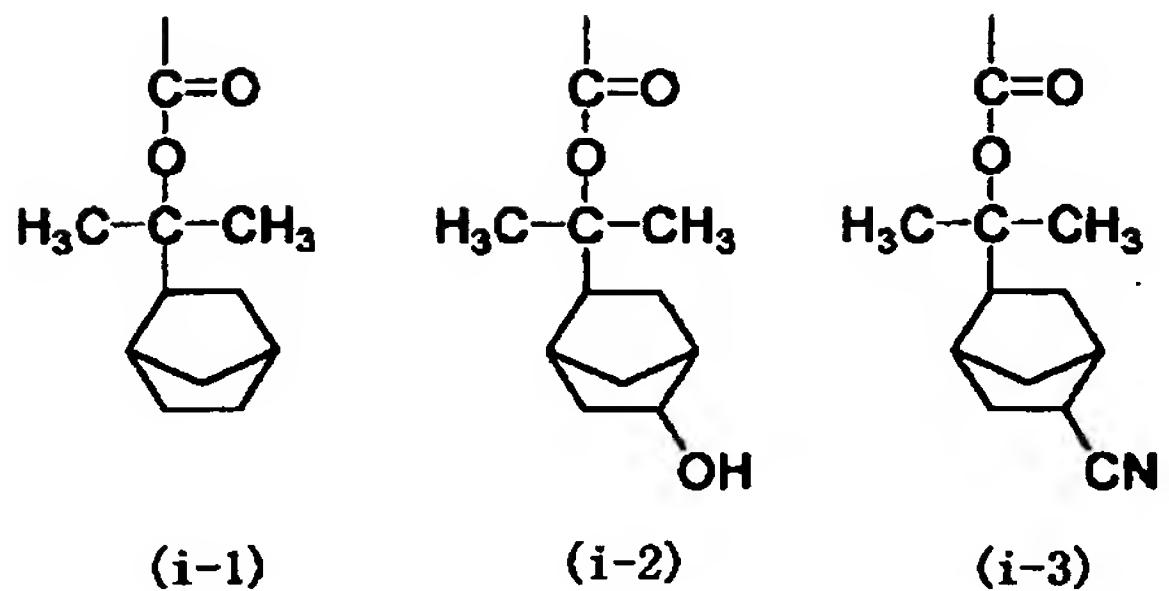
シクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これららの脂環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1～4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。これらの脂環式炭化水素基のうち、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたはアダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これらの脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等が好ましい。

【0020】また、前記脂環式炭化水素基の誘導体としては、例えば、ヒドロキシル基；カルボキシル基；オキソ基（即ち、=O基）；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1～4のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-ブロボキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロボキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1～4のアルコキシル基；シアノ基；シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭素数2～5のシアノアルキル基等の置換基を1種以上あるいは1個以上有する基を挙げることができる。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

【0021】また、R²およびR³の炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基が好ましい。

【0022】一般式(1-1)における基-COO_C(R²)₂および一般式(1-2)における基-COO_C(R³)₂は、酸の作用により解離してカルボキシル基を形成する酸解離性基をなしている。以下では、この基を酸解離性基(i)という。好ましい酸解離性基(i)の具体例としては、t-ブトキシカルボニル基や、下記式(i-1)～(i-49)の基等を挙げることができる。

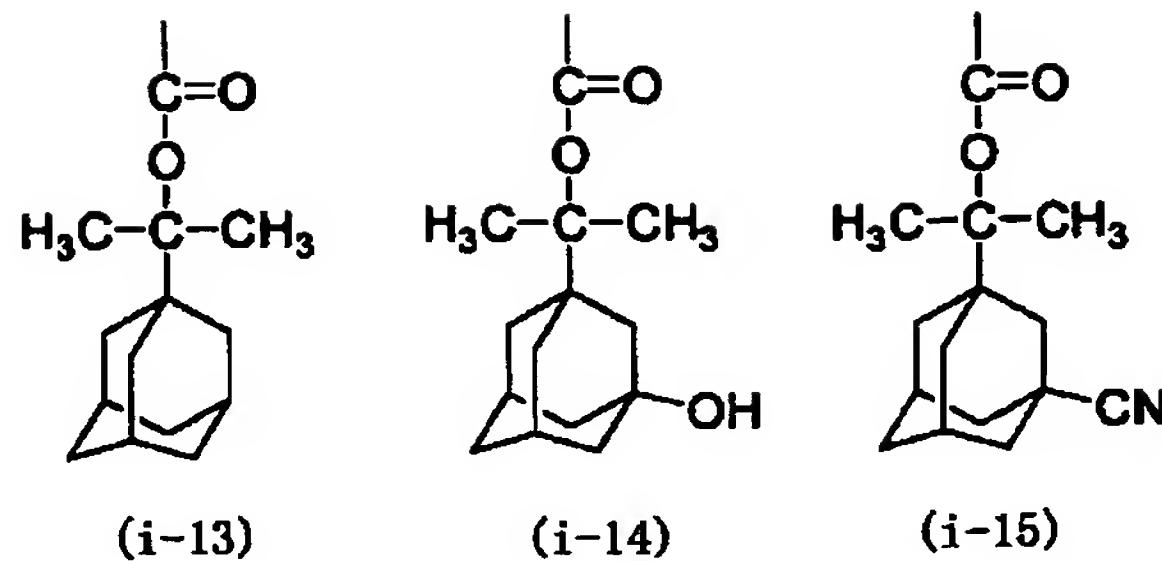
【0023】
【化12】



13

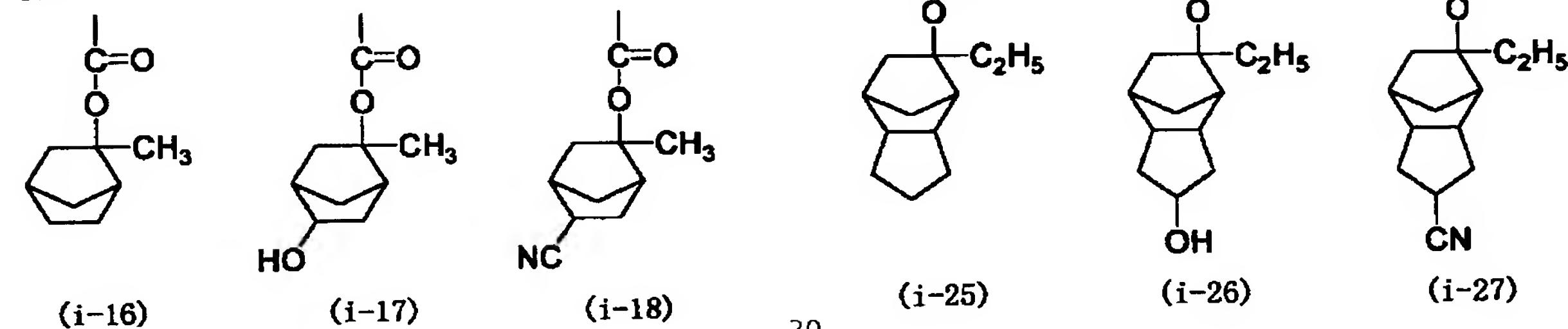
14

【化16】



【0028】

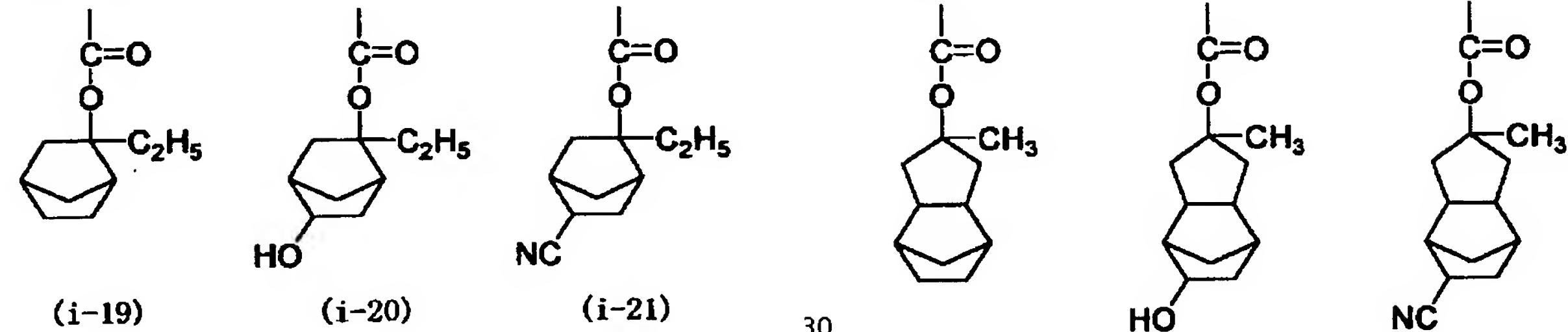
【化17】



20

【0029】

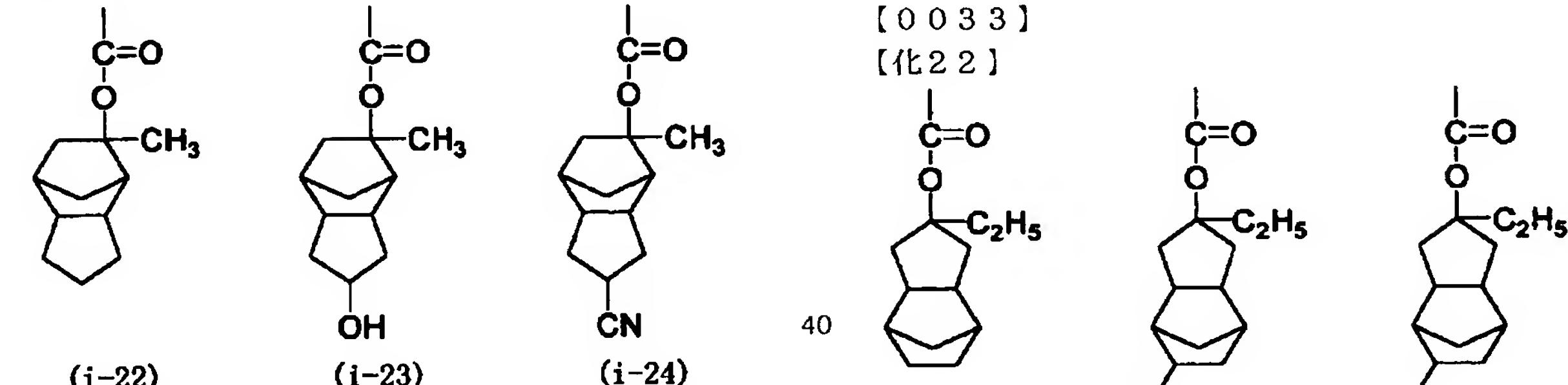
【化18】



30

【0030】

【化19】

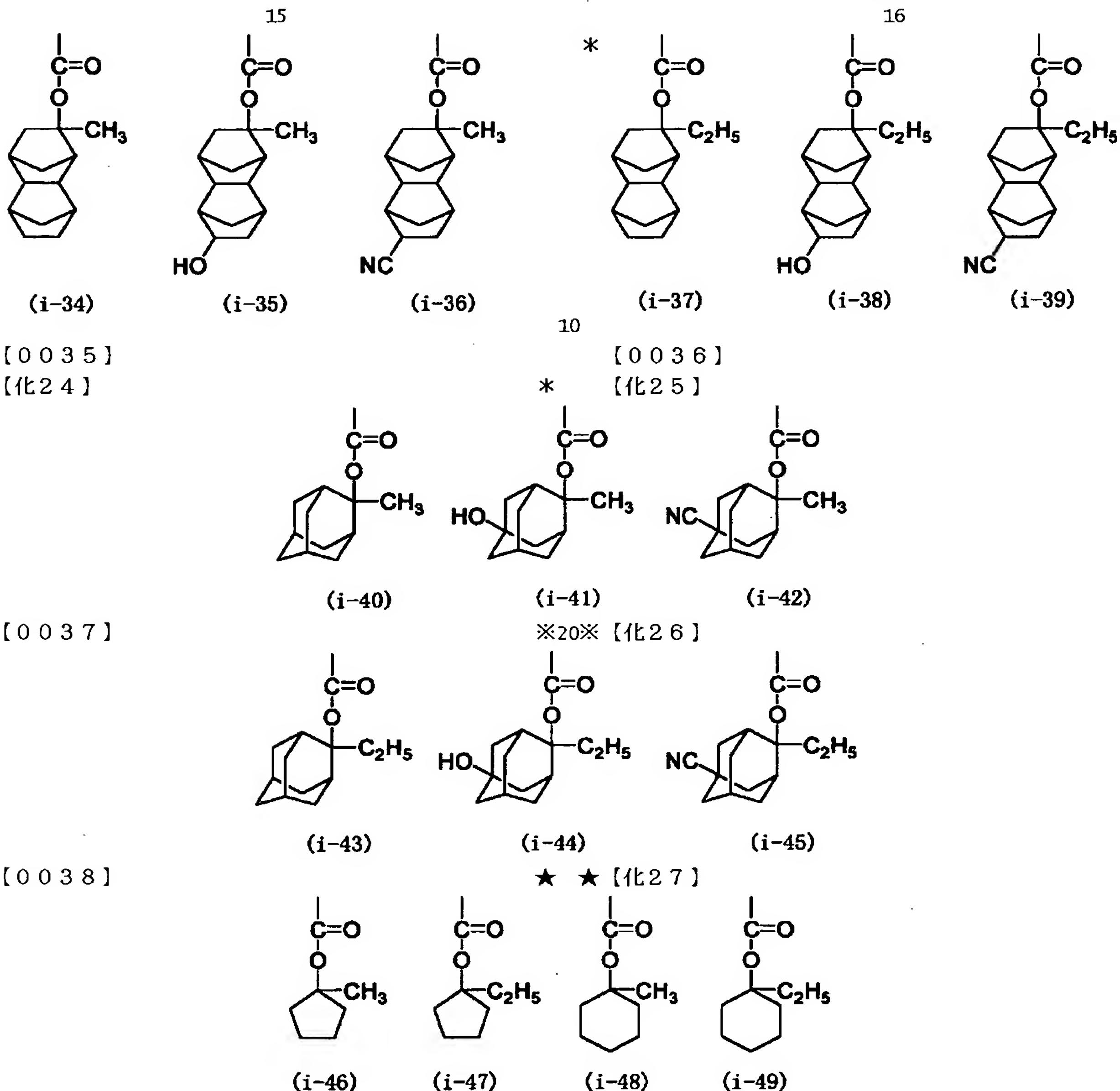


40

【0031】

【化20】

【0034】
【化23】



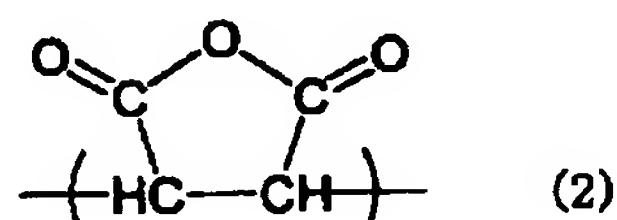
【0039】これらの酸解離性基(i)のうち、*t*-ブトキシカルボニル基や、式(i-1)、式(i-2)、式(i-10)、式(i-11)、式(i-13)、式(i-14)、式(i-16)、式(i-17)、式(i-34)、式(i-35)、式(i-40)、式(i-41)、式(i-43)、式(i-45)、式(i-46)、式(i-47)、式(i-48)または式(i-49)の基等が好ましく、特に繰り返し単位(1-2)の場合、式(i-40)または式(i-43)の基が好ましい。また、一般式(1-2)におけるnとしては、0または1が好ましい。樹脂(A)において、繰り返し単位(1-1)および繰り返し単位(1-2)は、それぞれ単独でまたは2種以上が存在することができる。繰り返し単位(1-1)は、対応する(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰り返し単位であり、また繰り返し単位(1-2)は、対応するノルボルネン(即ち、ビシクロ[2.2.1]

ヘプト-2-エン)誘導体に由来する繰り返し単位である。

【0040】樹脂(A)は、繰り返し単位(1-1)および繰り返し単位(1-2)以外の繰り返し単位(以下、「他の繰り返し単位」という。)を有することもできる。好ましい他の繰り返し単位としては、例えば、下記一般式(2)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(2)」といふ。)を挙げることができる。

【0041】

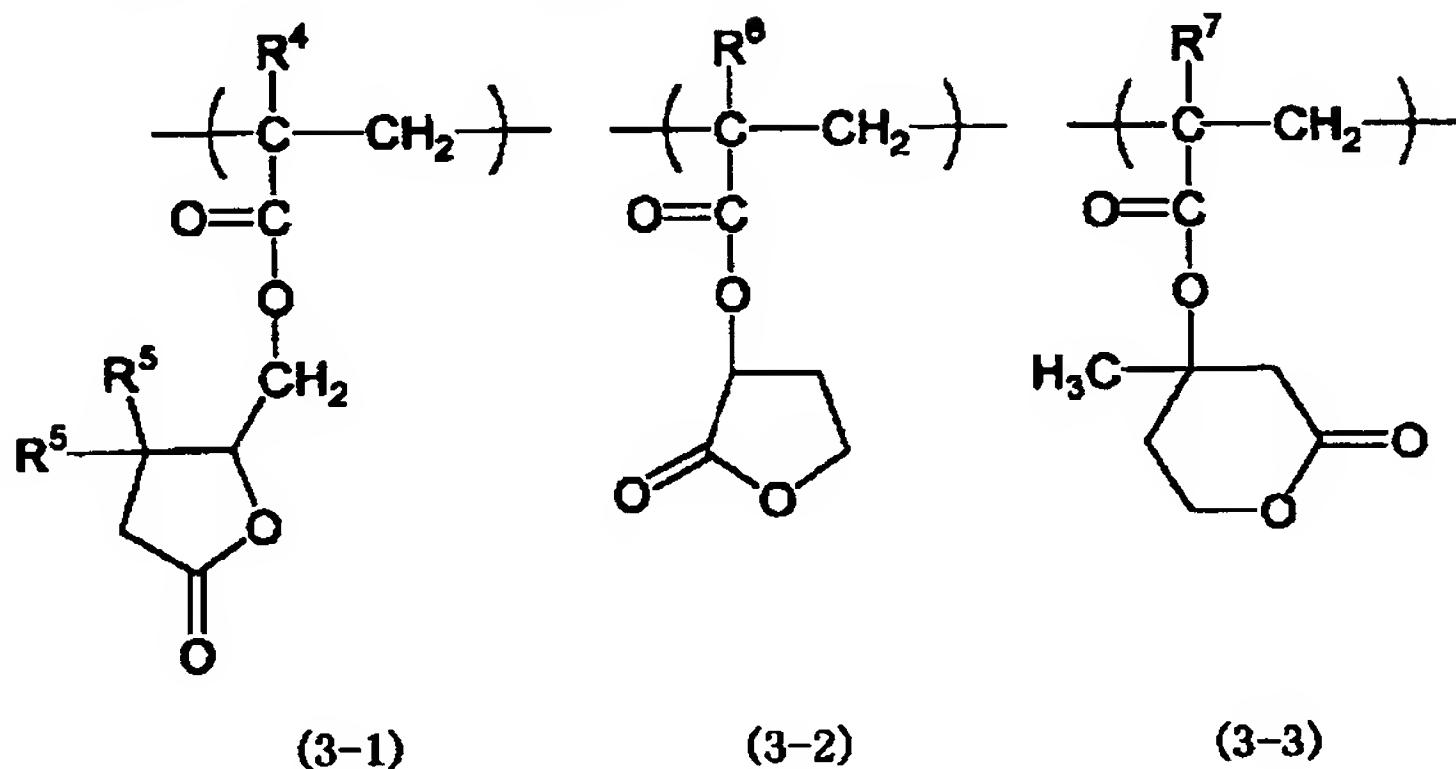
【化28】



50 繰り返し単位(2)は、無水マレイン酸に由来する繰り

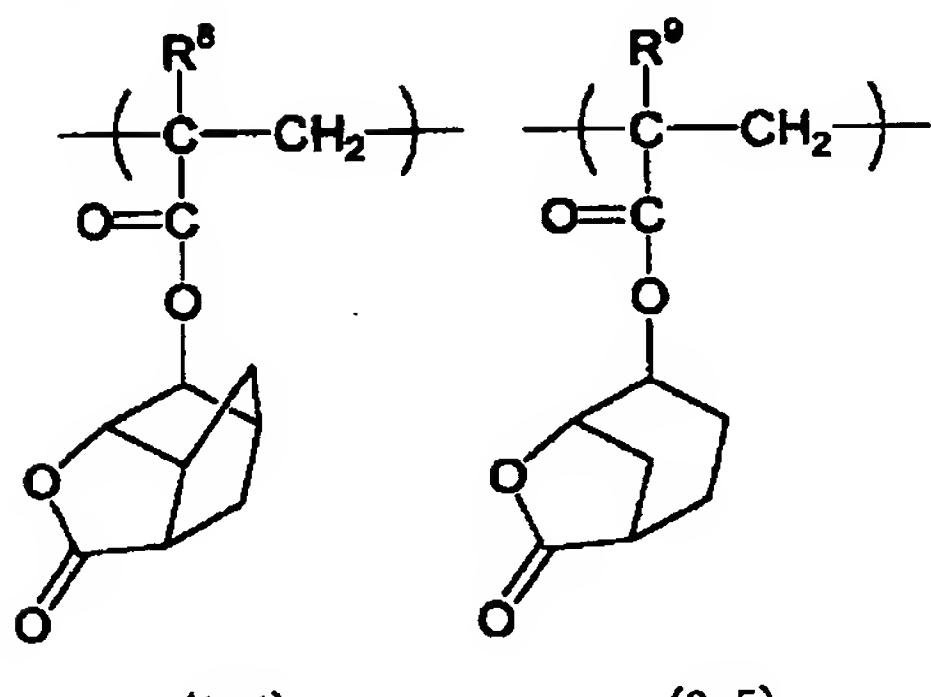
返し単位である。

【0042】また、繰り返し単位(2)以外の好ましい他の繰り返し単位としては、例えば、下記一般式(3-1)、一般式(3-2)、一般式(3-3)、一般式*



【0044】

【化30】



(3-4)

(3-5)

【0045】〔一般式(3-1)～(3-5)において、R⁴、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸およびR⁹は相互に独立に水素原子またはメチル基を示す。〕

以下では、一般式(3-1)～(3-5)で表される繰り返し単位を、順次、繰り返し単位(3-1)、繰り返し単位(3-2)、繰り返し単位(3-3)、繰り返し単位(3-4)および繰り返し単位(3-5)という。繰り返し単位(3-1)～(3-5)はそれぞれ、対応する(メタ)アクリル酸誘導体に由来する繰り返し単位である。

【0046】樹脂(A)は、繰り返し単位(2)および繰り返し単位(3-1)～(3-5)以外の他の繰り返し単位(以下、「他の繰り返し単位(α)」といふ。)を有することもできる。他の繰り返し単位(α)を与える重合性不飽和单量体としては、例えば、(メタ)アクリル酸ノルボルニル、(メタ)アクリル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸トリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸テトラシクロデカニル、(メタ)アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ)アクリル酸アダマンチル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシアダマンチル、(メタ)アクリル酸アダマンチルメチル等の有橋式炭化水素

* (3-4)または一般式(3-5)で表される繰り返し単位を挙げることができる。

【0043】

【化29】

骨格を有する(メタ)アクリル酸エステル類；(メタ)アクリル酸カルボキシノルボルニル、(メタ)アクリル酸カルボキシトリシクロデカニル、(メタ)アクリル酸カルボキシテトラシクロデカニル等の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格を有するカルボキシル基含有エステル類；

【0047】ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ブロビルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ブチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ベンチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-n-ヘキシルビシクロ[2.

2.1]ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、テトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-n-ブロビルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-n-ブチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-n-ベンチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-n-ヘキシルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-ヒドロキシメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、

【0048】8-フルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2,5}.1^{7,10}]ドデカ-3-エン、8-ジフルオロメチルテトラシクロ[4.

4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-ペンタフルオロエチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8-ジフルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,9-ジフルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-メチル-8-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、
【0049】8,8,9-トリフルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8,9-トリス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8,9-テトラフルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8,9-テトラキス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8-ジフルオロ-9,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,9-ジフルオロ-8,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8,9-トリフルオロ-9-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,8,9-トリフルオロ-9-トリフルオロメトキシテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、
【0050】8,8,9-トリフルオロ-9-ペンタフルオロプロポキシテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-フルオロ-8-ペンタフルオロエチル-9,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,9-ジフルオロ-8-ヘプタフルオロイソプロピル-9-トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-クロロ-8,9,9-トリフルオロテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8,9-ジクロロ-8,9-ビス(トリフルオロメチル)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-(2',2',2'-トリフルオロカルボエトキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、8-メチル-8-(2',2',2'-トリフルオロカルボエトキシ)テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] ドデカ-3-エン、
【0051】ジシクロペンタジエン、トリシクロ[5.2.1.0^{2.5}] デカ-8-エン、トリシクロ[5.2.1.0^{2.5}] デカ-3-エン、トリシクロ[4.

20 4. 0. 1^{2.5}] ウンデカ-3-エン、トリシクロ[6.2.1.0^{1.8}] ウンデカ-9-エン、トリシクロ[6.2.1.0^{1.8}] ウンデカ-4-エン、テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}.0^{1.6}] ドデカ-3-エン、8-メチルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}.0^{1.6}] ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.12}] ドデカ-3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}.0^{1.6}] ドデカ-3-エン、ペンタシクロ[6.5.1.1^{3.6}.0^{2.7}.0^{9.13}] ペンタデカ-4-エン、ペンタシクロ[7.4.0.1^{2.5}.1^{9.12}.0^{8.13}] ペンタデカ-3-エン等の有橋式炭化水素骨格を有する他の単官能性单量体；
【0052】(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸n-プロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸2-メチルプロピル、(メタ)アクリル酸1-メチルプロピル、(メタ)アクリル酸t-ブチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸シクロプロピル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸4-メトキシシクロヘキシル、(メタ)アクリル酸2-シクロヘキシルオキシカルボニルエチル、(メタ)アクリル酸2-シクロヘキシルオキシカルボニルエチル、(メタ)アクリル酸2-(4-メトキシシクロヘキシル)オキシカルボニルエチル等の有橋式炭化水素骨格をもたない(メタ)アクリル酸エステル類；
【0053】 α -ヒドロキシメチルアクリル酸メチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸エチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸n-ブチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸n-ブチル等の α -ヒドロキシメチルアクリル酸エステル類；(メタ)アクリロニトリル、 α -クロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニトリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合物；(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物；N-(メタ)アクリロイルモルホリン、N-ビニル- ε -カプロラクタム、N-ビニルビロリドン、ビニルビリジン、ビニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物；(メタ)アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カルボン酸(無水物)類；(メタ)アクリル酸2-カルボキシエチル、(メタ)アクリル酸2-カルボキシプロピル、(メタ)アクリル酸3-カルボキシプロピル、(メ

タ) アクリル酸4-カルボキシブチル、(メタ) アクリル酸4-カルボキシシクロヘキシル等の不飽和カルボン酸の有橋式炭化水素骨格をもたないカルボキシル基含有エステル類；

【0054】 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -メトキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -エトキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -n-ブロボキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -i-ブロボキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -n-ブトキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(2-メチルブロボキシ) カルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(1-メチルブロボキシ) カルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -t-ブトキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -シクロヘキシカルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(4-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(1-エトキシエトキシ) カルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -(1-シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロフラニルオキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロビラニルオキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン等の酸解離性基を有する(メタ) アクリロイルオキシラクトン化合物；

【0055】 α -メトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -エトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -n-ブロボキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -i-ブロボキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -n-ブトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -t-ブトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -t-ブチルプロボキシ- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-メチルブロボキシ) カルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-メチルブロボキシ) カルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -シクロヘキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(4-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ

22
- γ -ブチロラクトン、 α -フェノキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-エトキシエトキシ) カルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(1-シクロヘキシルオキシエトキシ) カルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -t-ブトキシカルボニルメトキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロフラニルオキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -テトラヒドロビラニルオキシカルボニル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン等の酸解離性基を有する(メタ) アクリロイルオキシラクトン化合物；
【0056】 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -フルオロ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -ヒドロキシ- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -メチル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -ジメチル- γ -ブチロラクトン、 α -(メタ) アクリロイルオキシ- β -メトキシ- γ -ブチロラクトン、 α -フルオロ- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -ヒドロキシ- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -メチル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -エチル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -ジメチル- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -メトキシ- β -(メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン、 α -メバロノラクトン等の酸解離性基をもたない(メタ) アクリロイルオキシラクトン化合物等の単官能性单量体や、
【0057】1, 2-アダマンタンジオールジ(メタ) アクリレート、1, 3-アダマンタンジオールジ(メタ) アクリレート、1, 4-アダマンタンジオールジ(メタ) アクリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ) アクリレート等の有橋式炭化水素骨格を有する多官能性单量体；
【0058】メチレングリコールジ(メタ) アクリレート、エチレングリコールジ(メタ) アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ) アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ(メタ) アクリレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ヘキサンジオールジ(メタ) アクリレート、1, 8-オクタンジオールジ(メタ) アクリレート、1, 9-ノナンジオールジ(メタ) アクリレート、1, 4-ビス(2-ヒドロキシプロピル) ベンゼンジ(メタ) アクリレート、1, 3-ビス(2-ヒドロキシプロピル) ベンゼンジ(メタ) アクリレート等の有橋式炭化水素骨格をもたない多官能性单量体等の多官能性单

量体を挙げることができる。本発明において、他の繰り返し単位は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

【0059】樹脂(A)において、(1-1)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、10~40モル%、好ましくは10~30モル%、さらに好ましくは10~25モル%である。この場合、繰返し単位(1-1)の含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方40モル%を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。また、繰返し単位(1-2)含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、5~30モル%、好ましくは10~30モル%、さらに好ましくは15~30モル%である。この場合、繰返し単位(1-2)の含有率が5モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方30モル%を超えると、レジストとしての現像性や組成物の貯蔵安定性が低下する傾向がある。また、繰返し単位(1-1)の繰返し単位(1-2)に対するモル比〔繰返し単位(1-1)／繰返し単位(1-2)〕は、好ましくは0.5~2、さらに好ましくは0.8~2、特に好ましくは0.8~1.5である。この場合、前記モル比が0.5より小さいと、レジストとしての現像性が低下する傾向があり、一方2を超えると、レジストとしての解像度や組成物の貯蔵安定性が低下する傾向がある。

【0060】また、他の繰り返し単位の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、70モル%以下、好ましくは50モル%以下である。また、繰り返し単位(2)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、40モル%以下、好ましくは10~40モル%、さらに好ましくは10~35モル%である。この場合、繰り返し単位

(2)の含有率が40モル%を超えると、組成物の貯蔵安定性が低下する傾向がある。なお、繰り返し単位

(2)の含有率が10モル%未満であると、繰り返し単位(1-1)を与える不飽和单量体と繰り返し単位(1-2)を与える不飽和单量体との共重合性が低下して、所望の高分子量の樹脂が得られ難くなるおそれがある。また、繰り返し単位(3-1)~(3-5)の合計含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、40モル%以下、好ましくは5~40モル%、さらに好ましくは10~30モル%である。この場合、前記合計含有率が40モル%を超えると、溶剤への溶解性が低下する傾向がある。なお、前記合計含有率が5モル%未満であると、レジストとしての解像度や現像性が不十分となるおそれがある。

【0061】樹脂(A)は、例えば、その各繰り返し単位に対応する重合性不飽和单量体を、ヒドロバーオキシド類、ジアルキルバーオキシド類、ジアシルバーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で重合する

ことにより製造することができる。前記重合に使用される溶媒としては、例えば、n-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘプタン、n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等のアルカン類；シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類；ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類；クロロブタン類、プロモヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類；酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン酸メチル等の飽和カルボン酸エステル類；2-ブタノン、4-メチル-2-ペンタノン、2-ヘプタノン等のケトン類；テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等のエーテル類等を挙げることができる。これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。また、前記重合における反応温度は、通常、40~120°C、好ましくは50~90°Cであり、反応時間は、通常、1~48時間、好ましくは1~24時間である。

【0062】樹脂(A)のゲルバーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算重量平均分子量(以下、「M_w」という。)は、通常、3,000~30,000、好ましくは5,000~30,000、さらに好ましくは5,000~20,000である。この場合、樹脂(A)のM_wが3,000未満では、レジストとしたときの耐熱性が低下する傾向があり、一方30,000を超えると、レジストとしたときの現像性が低下する傾向がある。また、樹脂(A)のM_wとゲルバーミエーションクロマトグラフィ(GPC)によるポリスチレン換算数平均分子量(以下、「M_n」という。)との比(M_w/M_n)は、通常、1~5、好ましくは1~3である。なお、樹脂(A)は、ハロゲン、金属等の不純物が少ないほど好ましく、それにより、レジストとしたときの感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等をさらに改善することができる。樹脂(A)の精製法としては、例えば、水洗、液々抽出等の化学的精製法や、これらの化学的精製法と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法との組み合わせ等を挙げることができる。

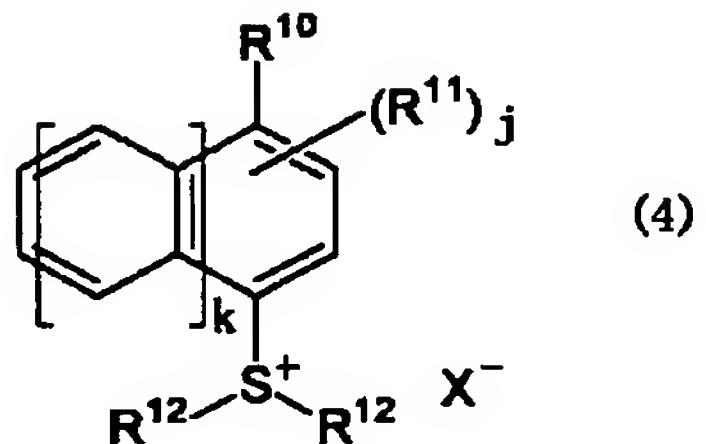
【0063】(B)成分

本発明における(B)成分は、露光により酸を発生する感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」といいう。)からなる。酸発生剤(B)は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを形成する作用を有するものである。本発明における酸発生剤(B)としては、下記一般式(4)で表されるイオン性化合物(以下、「化合物(4)」といいう。)と下記一般式(5)で表される非イオン性化合物(以下、「化

合物(5)」といふ。)との混合物を含むものが好ましい。

【0064】

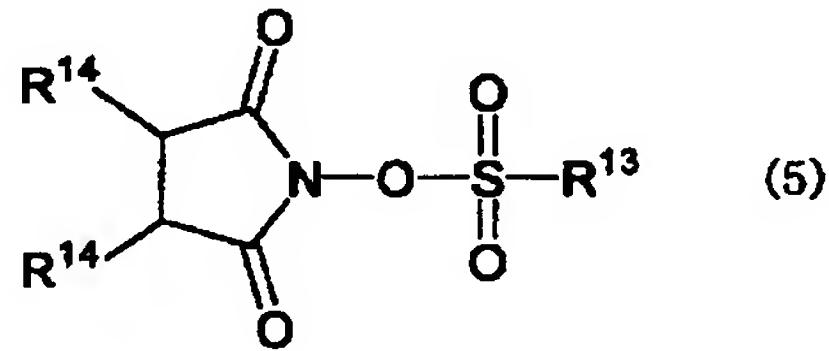
【化31】



【0065】(一般式(4)において、R¹⁰は水素原子、水酸基、炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基、炭素数2～11の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニル基を示し、R¹¹は水素原子または炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、jは0～3の整数であり、各R¹²は相互に独立に炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、置換されていてもよいフェニル基または置換基されていてもよいナフチル基を示すか、あるいは2つのR¹²が互いに結合して炭素数2～10の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよく、kは0～2の整数であり、X⁻はC_aF_{2a+1}SO₃⁻の構造を有するアニオンを示し、aは1～10の整数である。)

【0066】

【化32】



【一般式(5)において、R¹³はC_bF_{2b+1}基を示し、bは1～10の整数であり、各R¹⁴は相互に独立に水素原子または炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示すか、あるいは2つのR¹⁴が互いに結合して炭素数2～20の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよい。】

【0067】一般式(4)において、R¹⁰、R¹¹およびR¹²の炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-ブロピル基、i-ブロピル基、n-ブチル基、2-メチルブロピル基、1-メチルブロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、ネオベンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基等を挙げることができる。これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基、n-ブロピル基、n-ブチル基、t-ブチル基等が好ましい。

【0068】また、R¹⁰の炭素数1～10の直鎖状もし

くは分岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-ブロボキシ基、i-ブロボキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルブロボキシ基、1-メチルブロボキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオベンチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-ヘプチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキシ基等を挙げることができる。これらのアルコキシル基のうち、メトキシ基、エトキシ基、n-ブトキシ基、t-ブトキシ基等が好ましい。

【0069】また、R¹⁰の炭素数2～11の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-ブロボキシカルボニル基、i-ブロボキシカルボニル基、n-ブトキシカルボニル基、2-メチルブロボキシカルボニル基、1-メチルブロボキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基、n-ペンチルオキシカルボニル基、ネオベンチルオキシカルボニル基、n-ヘキシルオキシカルボニル基、n-ヘプチルオキシカルボニル基、n-オクチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシルオキシカルボニル基、n-ノニルオキシカルボニル基、n-デシルオキシカルボニル基等を挙げることができる。これらのアルコキシカルボニル基のうち、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基等が好ましい。

【0070】一般式(4)におけるR¹⁰としては、水素原子、水酸基、メトキシ基、エトキシ基、n-ブトキシ基等が好ましい。

【0071】一般式(4)におけるR¹¹としては、水素原子、メチル基、t-ブチル基等が好ましい。

【0072】一般式(4)において、R¹²の置換されていてもよいフェニル基としては、例えば、フェニル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基、4-エチルフェニル基等のフェニル基または炭素数1～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基で置換されたフェニル基；これらのフェニル基またはアルキル置換フェニル基を、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基等の1個以上あるいは1種以上で置換した基等を挙げることができる。

【0073】フェニル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基のうち、前記アルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-ブロボキシ基、i-ブロボキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルブロボキシ基、1-メチルブロボキシ基、t-ブトキシ基、シ

クロベンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基等の炭素数1～20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシル基等を挙げることができる。また、前記アルコキシアルキル基としては、例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基、1-メトキシエチル基、2-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、2-エトキシエチル基等の炭素数2～21の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシアルキル基等を挙げることができる。

【0074】また、前記アルコキシカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基、i-プロポキシカルボニル基、n-ブトキシカルボニル基、2-メチルブロボキシカルボニル基、1-メチルブロボキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基、シクロベンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル等の炭素数2～21の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシカルボニル基等を挙げることができる。また、前記アルコキシカルボニルオキシ基としては、例えば、メトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、n-プロポキシカルボニルオキシ基、i-プロポキシカルボニルオキシ基、n-ブトキシカルボニルオキシ基、t-ブトキシカルボニルオキシ基、シクロベンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル等の炭素数2～21の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシカルボニルオキシ基等を挙げることができる。

【0075】一般式(4)におけるR¹²の置換されていてもよいフェニル基としては、フェニル基、4-メトキシフェニル基等が好ましい。

【0076】また、R¹²の置換されていてもよいナフチル基としては、例えば、1-ナフチル基、2-メチル-1-ナフチル基、3-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、6-メチル-1-ナフチル基、7-メチル-1-ナフチル基、8-メチル-1-ナフチル基、2, 3-ジメチル-1-ナフチル基、2, 4-ジメチル-1-ナフチル基、2, 5-ジメチル-1-ナフチル基、2, 6-ジメチル-1-ナフチル基、2, 7-ジメチル-1-ナフチル基、2, 8-ジメチル-1-ナフチル基、3, 4-ジメチル-1-ナフチル基、3, 5-ジメチル-1-ナフチル基、3, 6-ジメチル-1-ナフチル基、3, 7-ジメチル-1-ナフチル基、3, 8-ジメチル-1-ナフチル基、4, 5-ジメチル-1-ナフチル基、5, 8-ジメチル-1-ナフチル基、4-エチル-1-ナフチル基2-ナフチル基、1-メチル-2-ナフチル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-2-ナフチル基等のナフチル基または炭素数1～10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基で置換されたナフチル基；これらのナフチル基またはアルキル置換ナフチル基を、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、ア

ルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基等の1個以上あるいは1種以上で置換した基等を挙げることができる。

【0077】ナフチル基およびアルキル置換ナフチル基に対する置換基であるアルコキシル基、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基およびアルコキシカルボニルオキシ基としては、例えば、前記フェニル基およびアルキル置換フェニル基について例示したそれぞれ対応する基を挙げができる。一般式(4)におけるR¹²の置換されていてもよいナフチル基としては、1-ナフチル基、4-メトキシ-1-ナフチル基等が好ましい。

【0078】また、2個のR¹²が互いに結合して形成した炭素数2～10の2価の基としては、式中の硫黄原子と共に5員または6員の環状構造、特に好ましくは5員の環状構造（即ち、テトラヒドロチオフェン環構造）を形成する基が望ましい。また、前記2価の基に対する置換基としては、例えば、前記フェニル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基として例示したヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基と同様のものを挙げができる。

【0079】一般式(4)におけるR¹²としては、メチル基、エチル基、t-ブチル基、フェニル基や、2個のR¹²が互いに結合して硫黄原子と共にテトラヒドロチオフェン環構造を形成する2価の基等が好ましい。

【0080】一般式(4)において、X⁻のC_aF_{2a+1}SO₃⁻中のC_aF_{2a+1}⁻基は、炭素数aのバーフルオロアルキル基であるが、該基は直鎖状もしくは分岐状であることができる。X⁻におけるaとしては、4または8が好ましい。

【0081】化合物(4)の具体例としては、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-ナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチルジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-ナフチルジメチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフチル)ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフチル)ジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフチル)ジメチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-

(4-ヒドロキシナフチル)ジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフチル)ジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフチル)ジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0082】1-(4-メチルナフチル)ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-メチルナフチル)ジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-メチルナフチル)ジメチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-メチルナフチル)ジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-メチルナフチル)ジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-メチルナフチル)ジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジメチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-シアノナフチル)ジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0083】1-(4-ニトロナフチル)ジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-ニトロナフチル)ジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-ニトロナフチル)ジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-ニトロナフチル)ジエチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-ニトロナフチル)ジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-ニトロナフチル)ジエチルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、

【0084】1-[1-(4-メトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-[1-(4-メトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-[1-(4-メトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホ

ネート、1-[1-(4-エトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-[1-(4-エトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-[1-(4-エトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-[1-(4-n-ブトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-[1-(4-n-ブトキシナフチル)]テトラヒドロチオフェニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート等を挙げることができる。

【0085】これらの化合物(4)のうち、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート等が好ましい。

【0086】一般式(5)において、R¹³のC_bF_{2b+1}-基は、炭素数bのバーフルオロアルキル基であるが、該基は直鎖状もしくは分岐状であることができる。R¹³におけるbとしては、4または8が好ましい。

【0087】一般式(5)において、R¹⁴の炭素数1～10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、前記一般式(4)におけるR¹⁰、R¹¹およびR¹²について例示した基と同様のものを挙げることができる。また、2つのR¹⁴が互いに結合して形成した炭素数2～20の2価の基は、主鎖が炭素鎖からなる基でも、主鎖に異項原子(例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等)を有する基でもよく、また主鎖が炭素鎖からなる2価の基は、例えば、直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基や、ノルボルナン環等の有橋式炭素環を有する基、ベンゼン環、ナフタレン環等の芳香族環を有する基でもよい。また、前記2価の基に対する置換基としては、例えば、前記フェニル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基として例示したヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基等を挙げることができる。

【0088】化合物(5)としては、例えば、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フタルイ

ミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、

【0089】N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、

【0090】N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ナフチルイミド等を挙げることができる。

【0091】これらの化合物(5)のうち、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-[(5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)スルホニルオキシ]スクシンイミド、N-[(5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル)スルホニルオキシ]ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキ

シ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド等が好ましい。

【0092】また、化合物(4)および化合物(5)以外の酸発生剤(以下、「他の酸発生剤」という。)としては、例えば、オニウム塩化合物、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物等を挙げることができる。前記オニウム塩化合物としては、例えば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩等を挙げることができる。オニウム塩化合物の具体例としては、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシル・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2-オキソシクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート等を挙げることができる。

【0093】前記ハロゲン含有化合物としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げることができる。ハロゲン含有化合物の具体例としては、フェニルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、4-メトキシフェニルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、1-ナフチルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン等の(トリクロロメチル)-s-トリアジン誘導体や、1, 1-ビス(4-クロロフェニル)-2, 2, 2-トリクロロエタン等を挙げることができる。前記ジアゾケトン化合物としては、例えば、1, 3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げることができる。ジアゾケトンの具体例としては、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルクロリド、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタンの1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙げることができる。前記スルホン化合物としては、例えば、β-ケトスルホン、β-スルホニルスルホンや、これらの化合物のα-ジアゾ化合物等を挙げることができる。スルホン化合物の具体例としては、4-トリスフェ

ナシルスルホン、メチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン等を挙げることができます。

【0094】前記スルホン酸化合物としては、例えば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げることができる。スルホン酸化合物の具体例としては、ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリス（トリフルオロメタノンスルホネート）、ニトロベンジル-9, 10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネート、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、バーフルオロ-n-オクタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)フタルイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(10-カンファースルホニルオキシ)ナフチルイミド、

[0095] N- (n-オクタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) フタルイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (n-オクタンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) フタルイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N- (p-トルエンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミ

ド、N-(p-トルエンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、

【0096】N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5,6-オキシ-2,3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5,6-オキシ-2,3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、

【0097】N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプタン-5,6-オキシ-2,3-ジカルボキシイミド、N-(バーフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド、N-(ナフタ

ンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシミド、N-(ナフタレンスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-[(5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-2-イル) スルホニルオキシ] スクシンイミド、N-[(5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-2-イル) スルホニルオキシ] ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシミド、

【0098】N-(ベンゼンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ) フタルイミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ) ジフェニルマレイミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシミド、N-(ベンゼンスルホニルオキシ) ナフチルイミド等を挙げることができる。

【0099】これらの他の酸発生剤のうち、ジフェニルヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムバーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、バーフルオロ-n-オクタニスルホニルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボジイミド、N-ヒドロキシスクシミドノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシミドバーフルオロ-n-オクタンスルホネート等が好ましい。

【0100】本発明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。本発明において、酸発生剤(B)の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂

(A) 100重量部に対して、通常、0.1~20重量部、好ましくは0.5~10重量部である。この場合、酸発生剤(B)の使用量が0.1重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方20重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向がある。また、酸発生剤(B)として、化合物(4)と化合物(5)との混合物を使用する場合における化合物(4)および化合物(5)の合計使用割合は、全酸発生剤(B)に対して、通常、60~100重量%、好ましくは70~100重量%、さらに好ましくは80~100重量%である。この場合、前記合計使用割合が60重量%未満で

は、レジストとしての解像度が低下する傾向がある。

【0101】(C)成分

本発明における(C)成分は、前記一般式(6-1)または一般式(6-2)で表される分子量1,000以下の化合物からなる。以下では、一般式(6-1)で表される分子量1,000以下の化合物を「化合物(C1)」といい、一般式(6-2)で表される分子量1,000以下の化合物を「化合物(C2)」といい、化合物(C1)と化合物(C2)とを含めたとき「化合物(C)」という。化合物(C)は、ドライエッチング耐性、バターン形状、基板との接着性等をさらに改善する作用を示す成分である。

【0102】一般式(6-1)および一般式(6-2)において、Yの炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体としては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタンや、シクロブタン、シクロペニタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これらの脂環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。これらの2価の脂環式炭化水素基のうち、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたはアダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これらの脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等が好ましい。

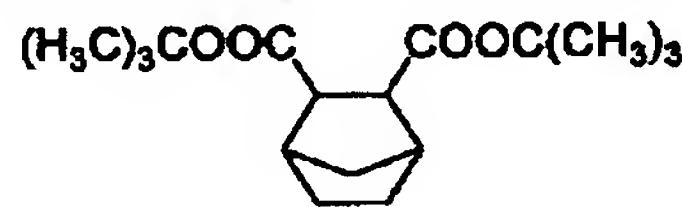
【0103】Yの炭素数4~20の2価の脂環式炭化水素基の誘導体における置換基としては、例えば、ヒドロキシル基；カルボキシル基；オキソ基(即ち、=O基)；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、n-ブロボキシ基、i-ブロボキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルブロボキシ基、1-メチルブロボキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基；シアノ基；シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等を挙げることができる。これらの置換基は1種以上あるいは1個以上存在することができる。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

【0104】また、Yの炭素数1~15の直鎖状もしくは分岐状の2価の炭化水素基としては、例えば、メチレ

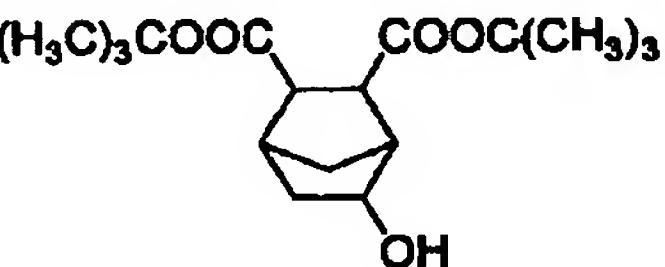
ン基、エチレン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、2, 5-ジメチル-2, 5-ヘキシレン基等を挙げることができる。これらの2価の炭化水素基のうち、テトラメチレン基、2, 5-ジメチル-2, 5-ヘキシレン基等が好ましい。

【0105】また、R¹⁵およびR¹⁶の炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基、何れか2つのR¹⁵あるいは何れか2つのR¹⁶が相互に結合して形成した炭素数4～20の2価の脂環式炭化水素基、および3つのR¹⁵あるいは3つのR¹⁶が相互に結合して形成した炭素数4～20の1価の脂環式炭化水素基としてはそれぞれ、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタンや、シクロブタン、シクロベンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これらの脂環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等の炭素数1～4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。これらの脂環式炭化水素基のうち、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンまたはアダマンタンに由来する脂環族環からなる基や、これらの脂環族環からなる基を前記アルキル基で置換した基等が好ましい。

【0106】前記脂環式炭化水素基の誘導体における置換基としては、例えば、前記Yの炭素数4～20の2価*

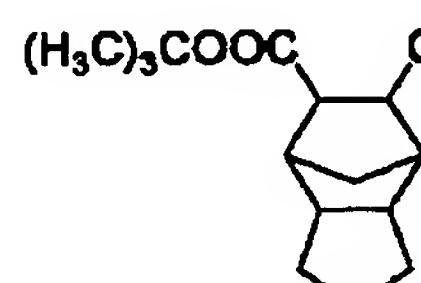


(C1-1)



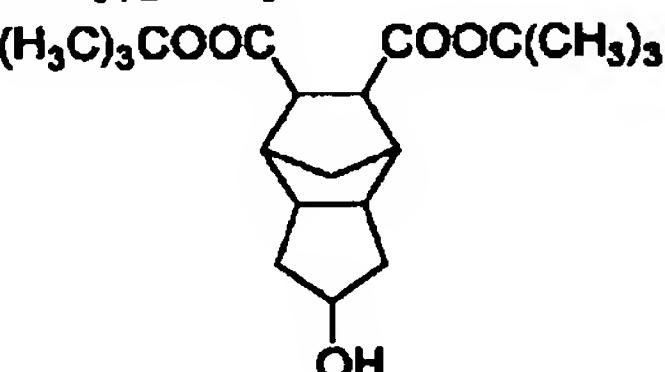
(C1-2)

【0111】



(C1-3)

※ ※ 【化34】



(C1-4)

【0112】

【化35】

*の脂環式炭化水素基の誘導体における置換基と同様のものを挙げることができる。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基等が好ましい。

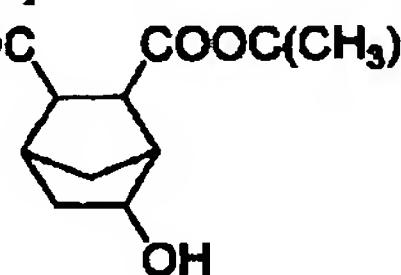
【0107】また、R¹⁵およびR¹⁶の炭素数1～4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としてはそれぞれ、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げることができ。これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基等が好ましい。

【0108】また、R¹⁵およびR¹⁶の-CH₂-R¹⁷基におけるR¹⁷の炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ドデシル基、n-テトラデシル基、n-ヘキサデシル基、n-オクタデシル基、エイコシル基等を挙げることができる。R¹⁵およびR¹⁶の-CH₂-R¹⁷基としては、1-エチル基、i-プロピル基等が好ましい。

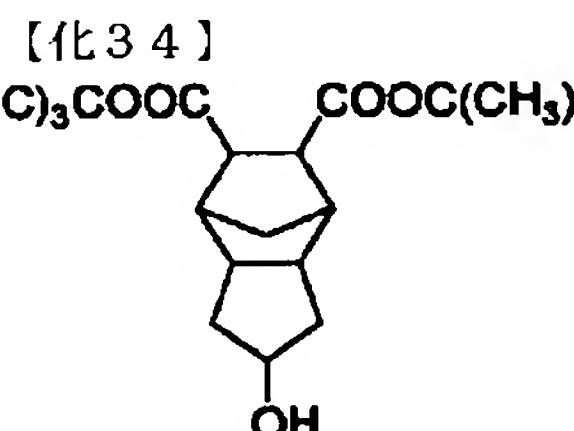
【0109】化合物(C1)の好ましい具体例としては、下記式(C1-1)～式(C1-53)で表される化合物等を挙げることができる。

【0110】

【化33】

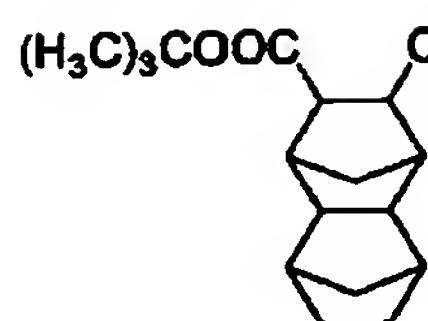


(C1-2)



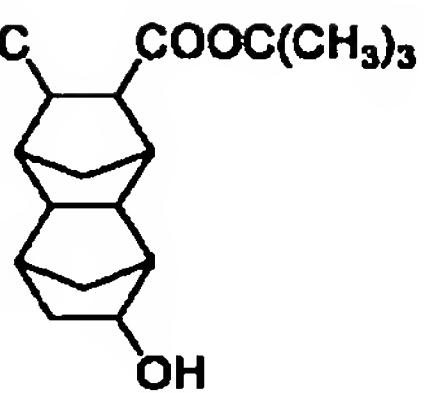
(C1-4)

39



(C1-5)

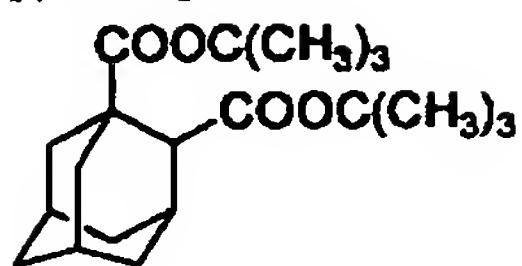
40



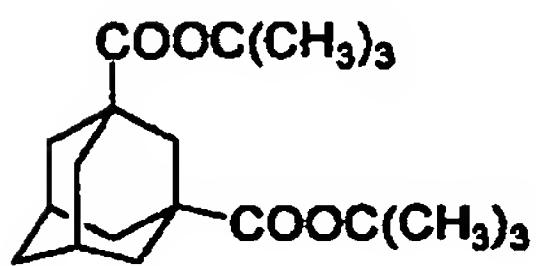
(C1-6)

【0113】

【化36】



(C1-7)



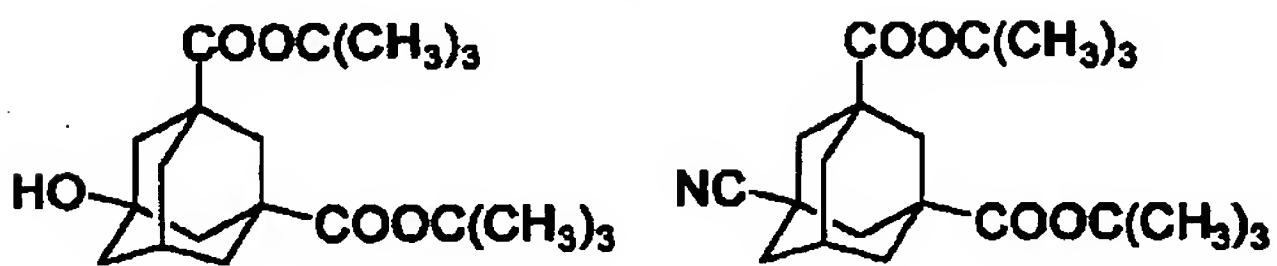
(C1-8)

10

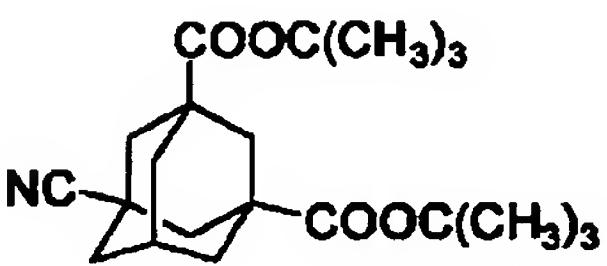
* 【0114】

【化37】

*

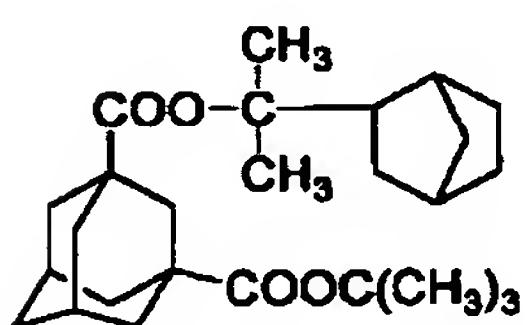


(C1-9)



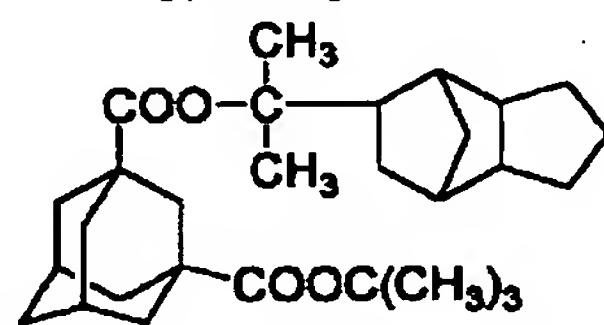
(C1-10)

【0115】



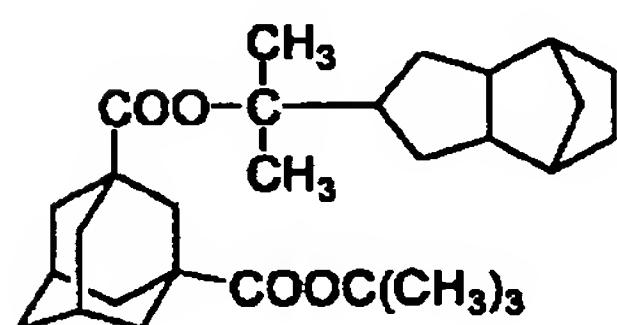
(C1-11)

* * 【化38】



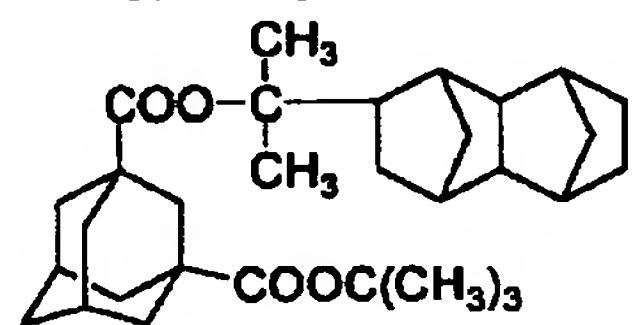
(C1-12)

【0116】



(C1-13)

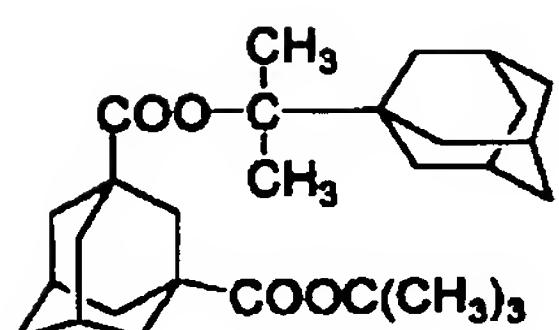
★30★ 【化39】



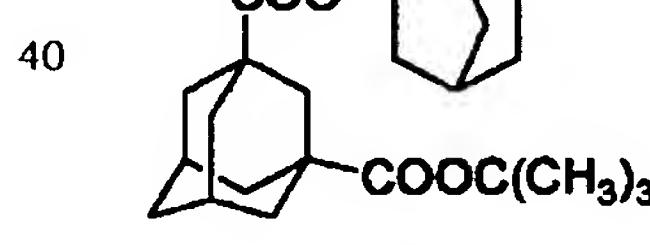
(C1-14)

【0117】

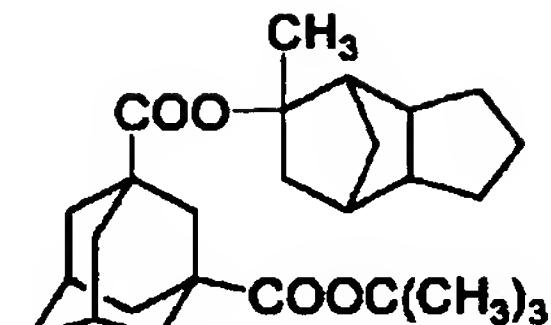
【化40】



(C1-15)



(C1-16)



(C1-17)

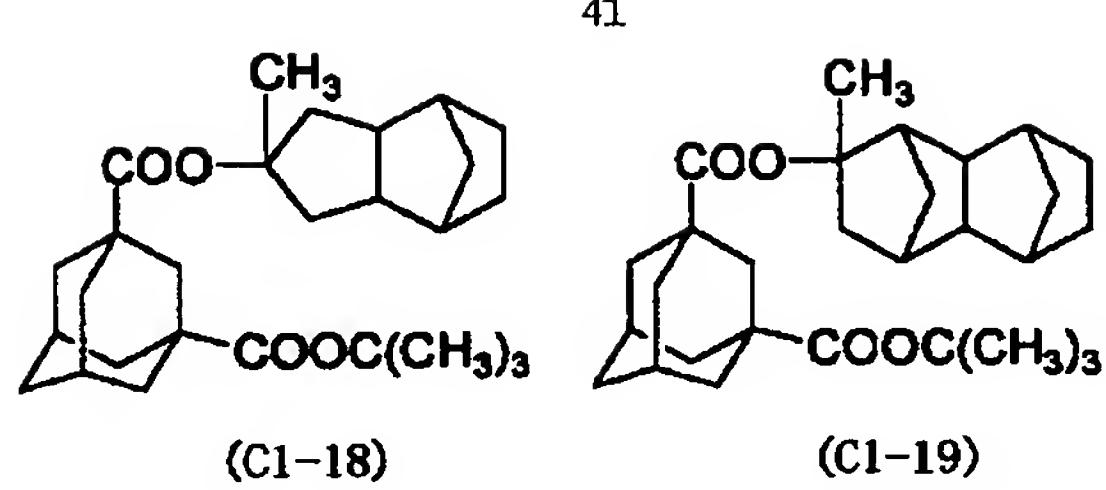
【0118】

【化41】

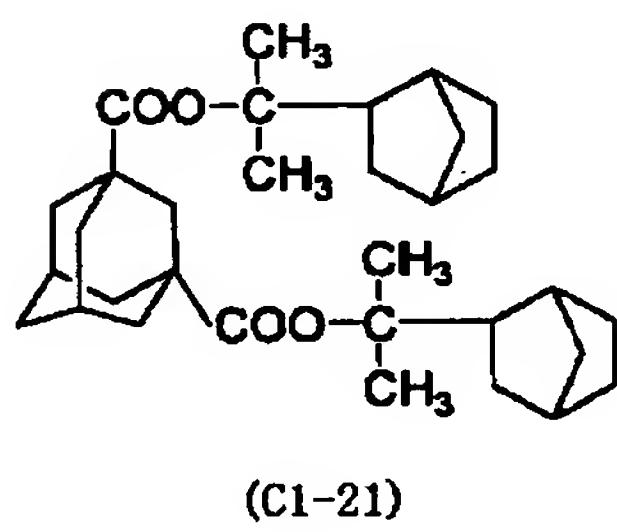
40

【0119】

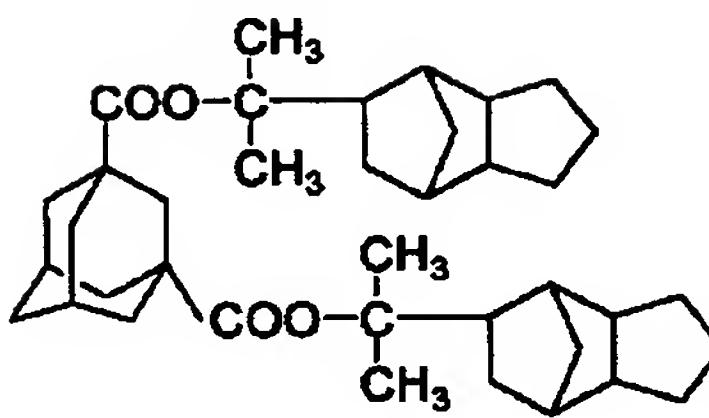
【化42】



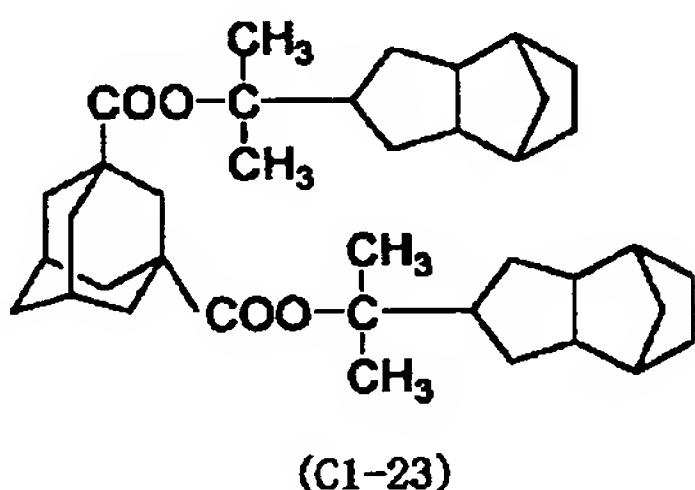
【0120】
【化43】



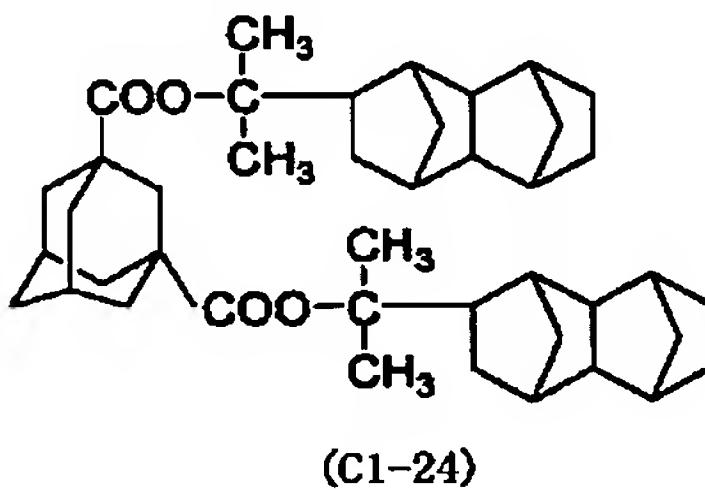
* 【0121】
【化44】



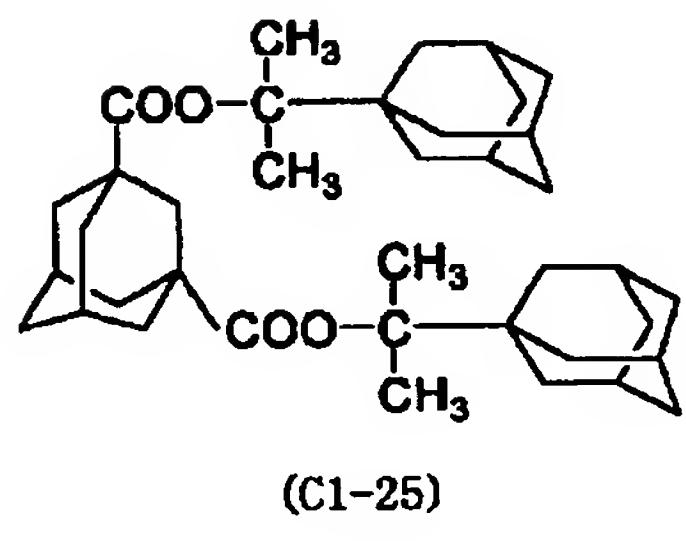
【0122】



* * 【化45】

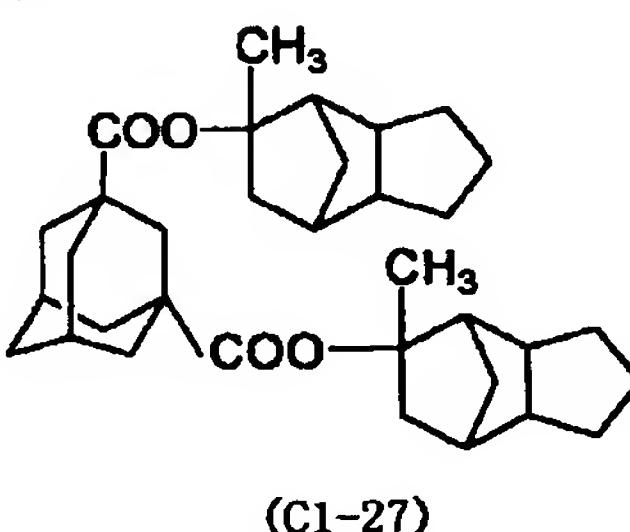


【0123】
【化46】



30

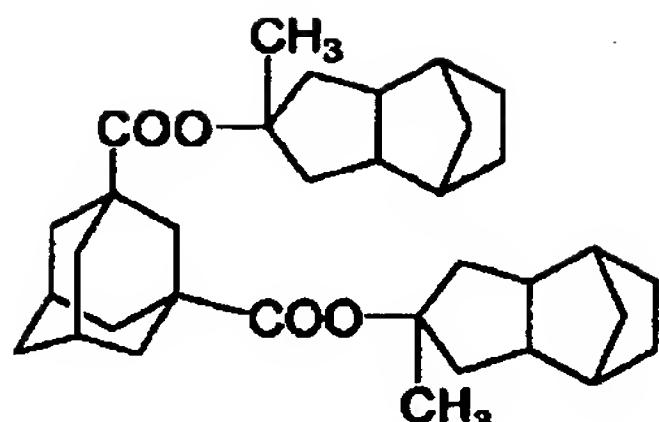
★



【0125】

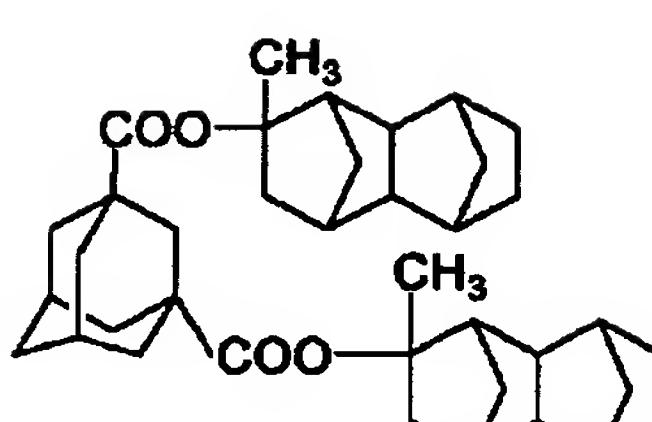
【化48】

43



(C1-28)

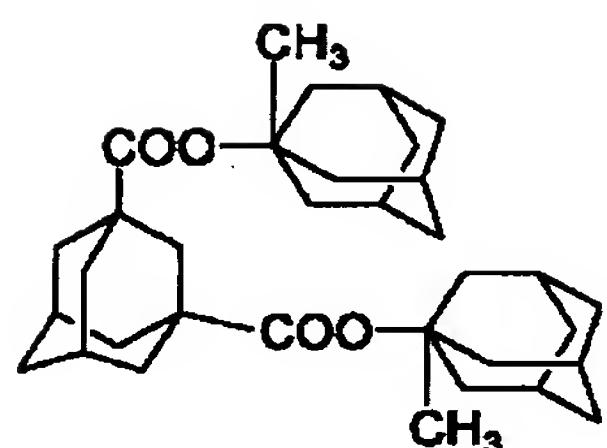
44



(C1-29)

[0126]

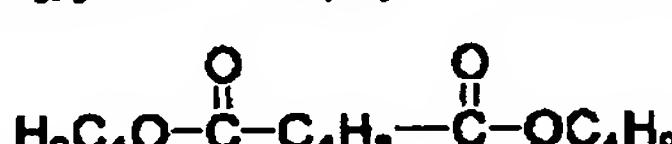
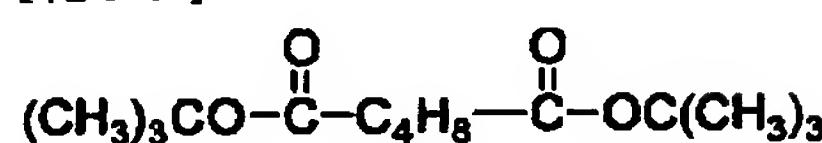
[化49]



(C1-30)

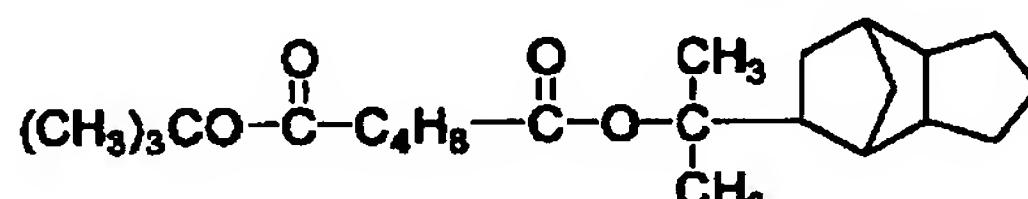
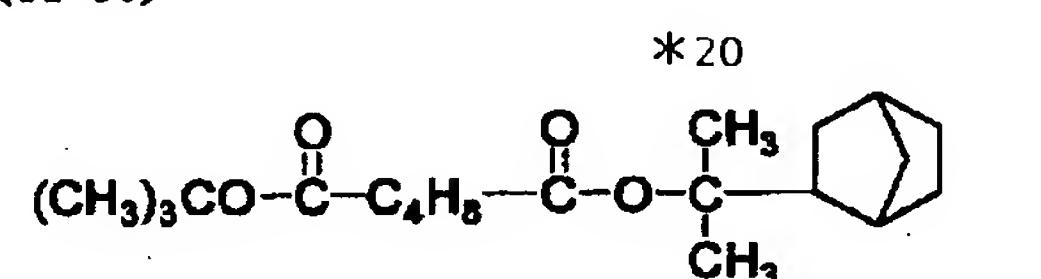
10* [0127]

[化50]

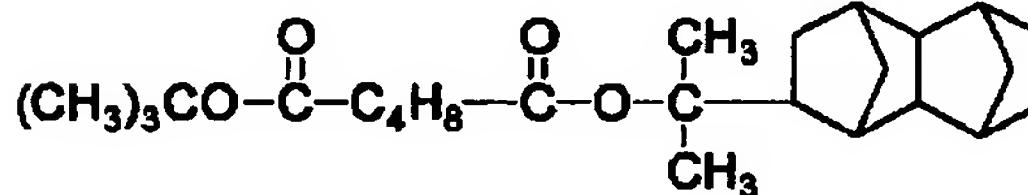
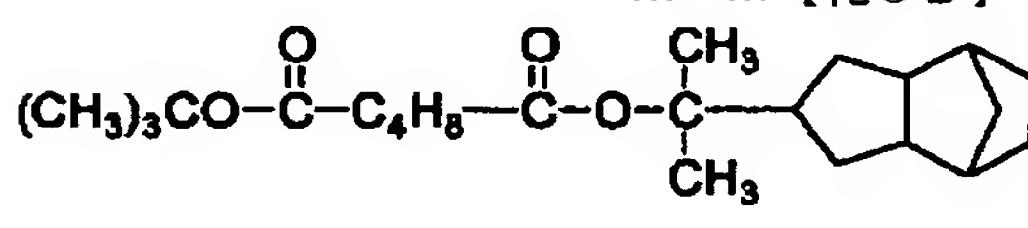


[0128]

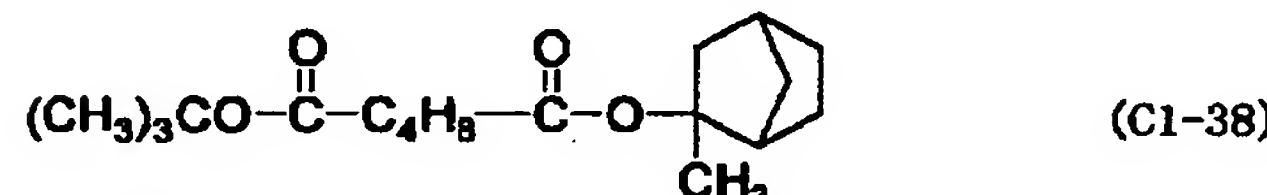
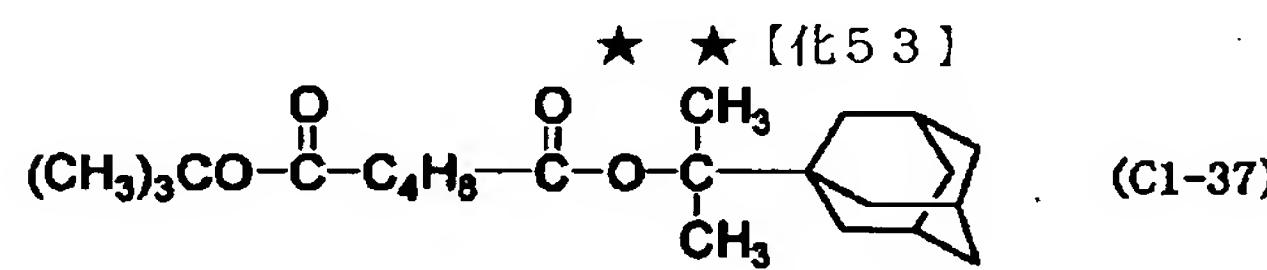
[化51]



[0129]



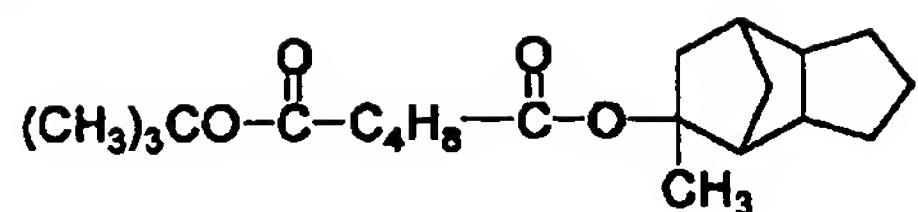
[0130]



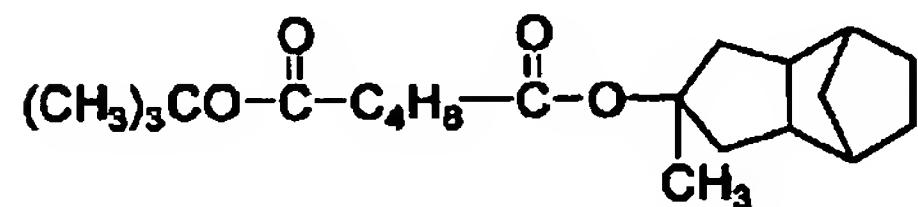
[0131]

[化54]

★ ★ [化53]



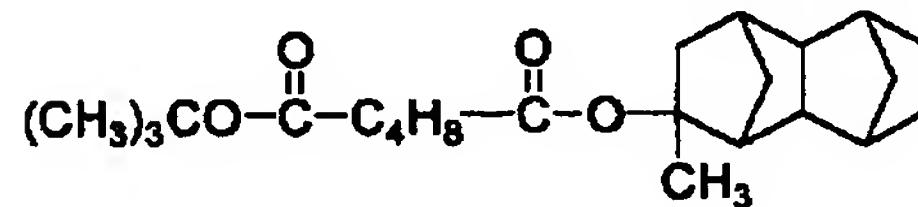
(C1-39)



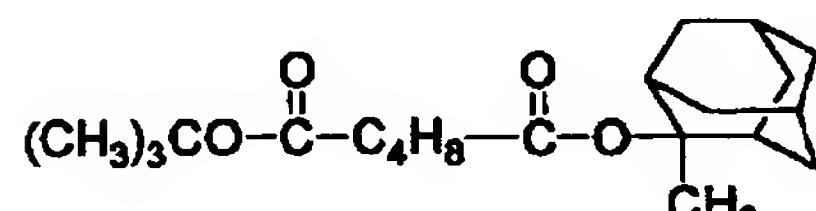
(C1-40)

【0132】

* * 【化55】



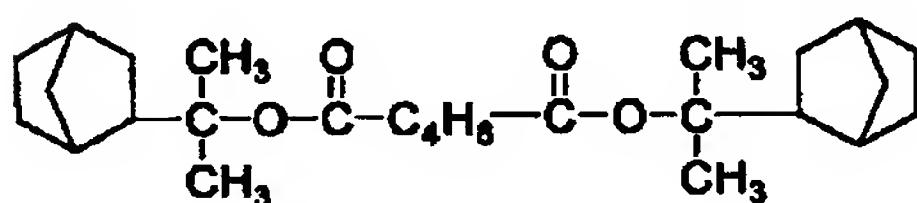
(C1-41)



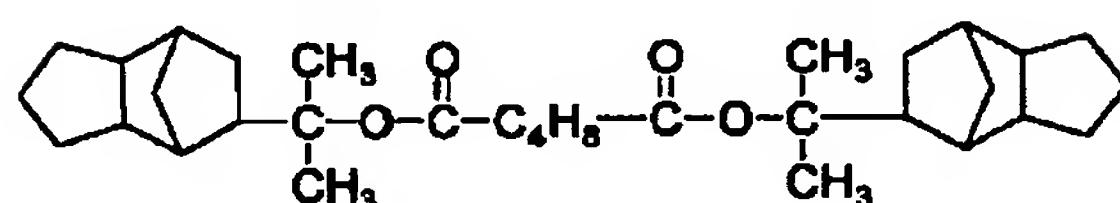
(C1-42)

【0133】

* * 【化56】



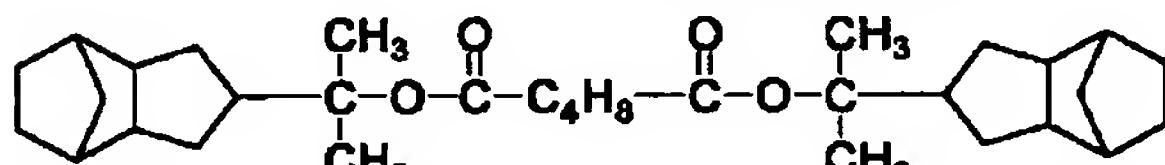
(C1-43)



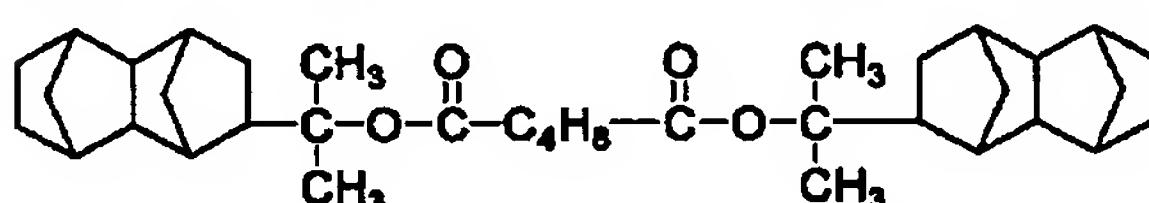
(C1-44)

【0134】

★ ★ 【化57】



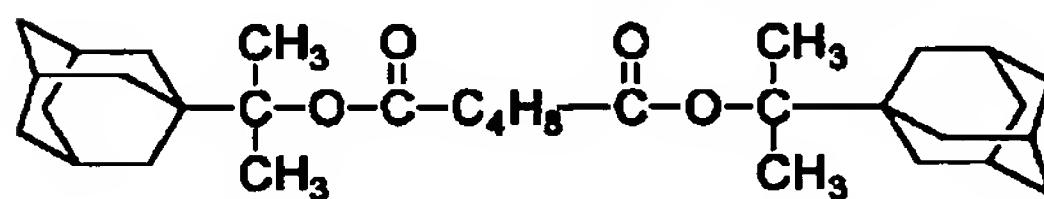
(C1-45)



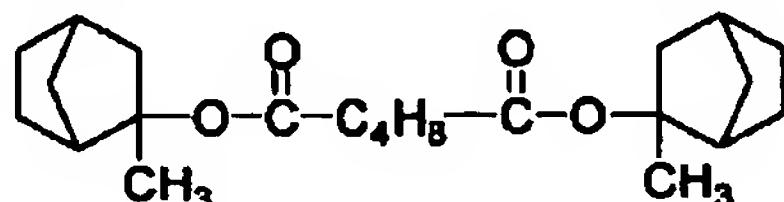
(C1-46)

【0135】

★ ★ 【化58】



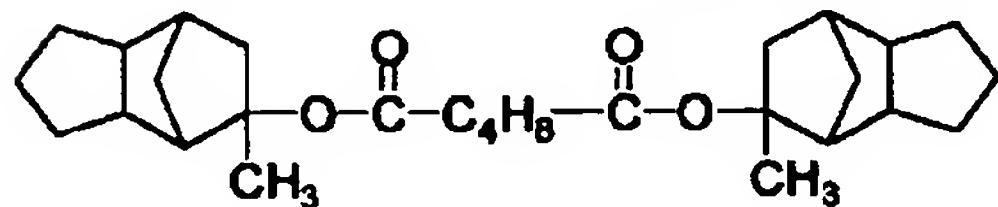
(C1-47)



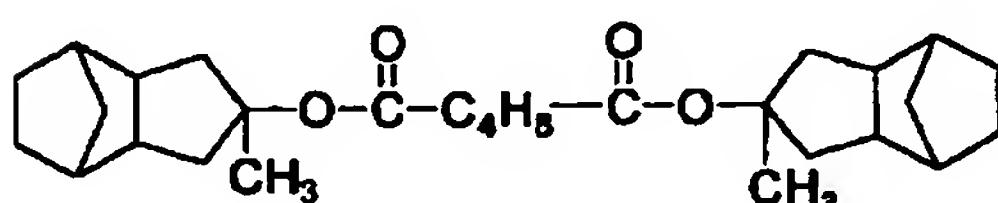
(C1-48)

【0136】

◆ ◆ 【化59】



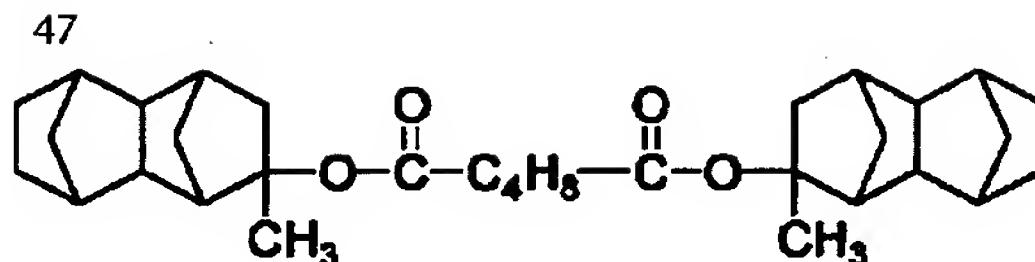
(C1-49)



(C1-50)

【0137】

【化60】

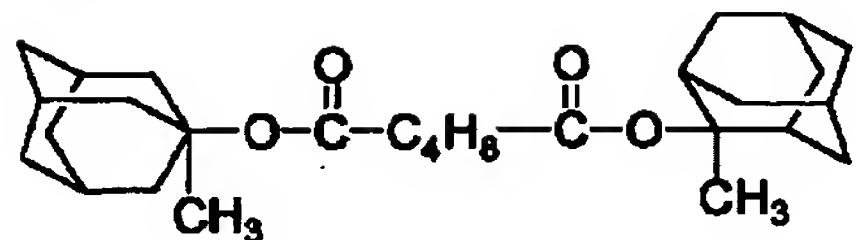


(C1-51)

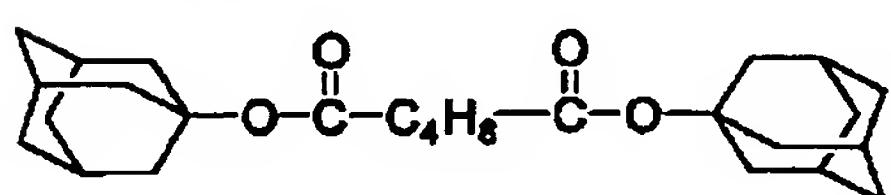
48

【0138】

【化61】



(C1-52)



(C1-53)

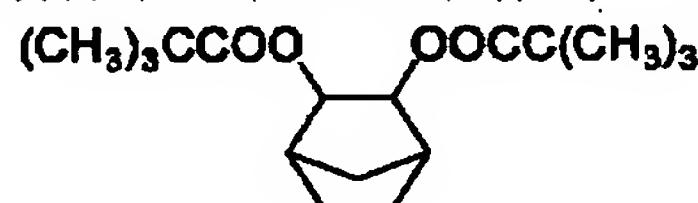
* (C1-8)、(C1-9)、(C1-21)、(C1-22)、(C1-25)、(C1-26)、(C1-30)、(C1-31)、(C1-43)、(C1-47)、(C1-48)または(C1-52)で表される化合物等が好ましい。

10 【0140】また、化合物(C2)の好ましい具体例としては、下記式(C2-1)～式(C2-17)で表される化合物等を挙げることができる。

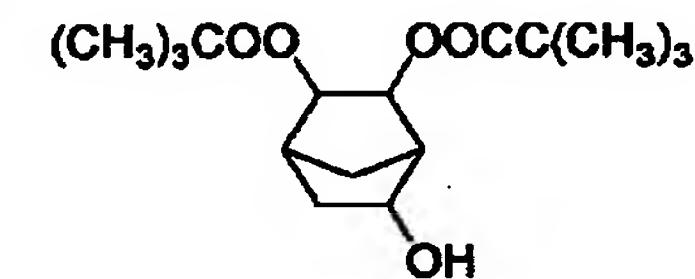
【0141】

【化62】

【0139】これらの化合物(C1)のうち、特に、*

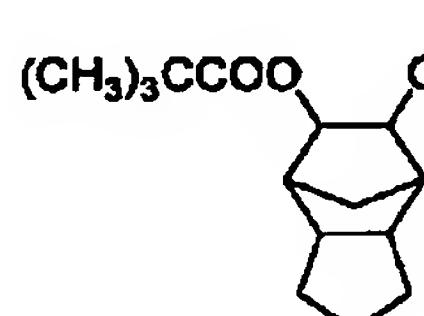


(C2-1)



(C2-2)

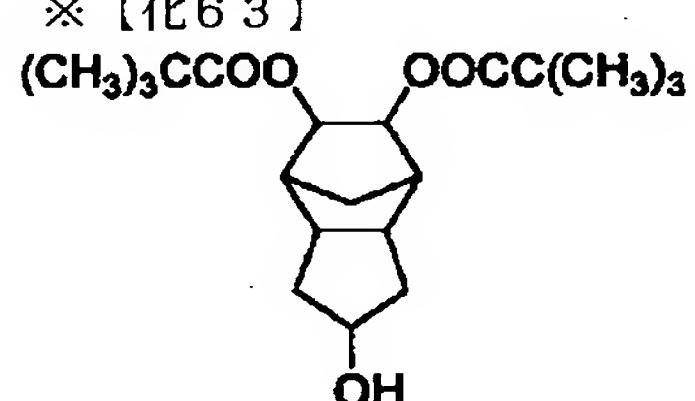
【0142】



(C2-3)

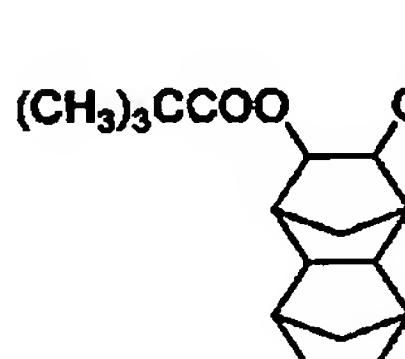
※

※【化63】



(C2-4)

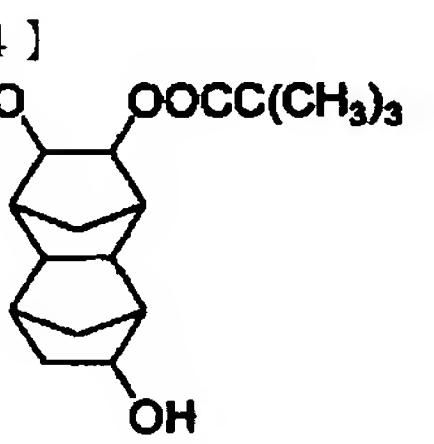
【0143】



(C2-5)

★

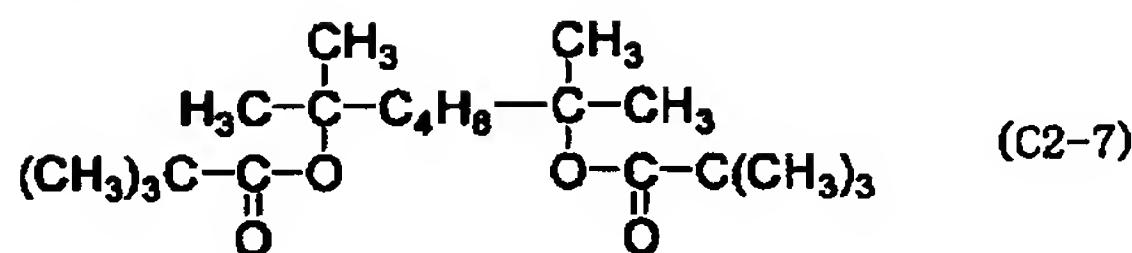
★【化64】



(C2-6)

【0144】

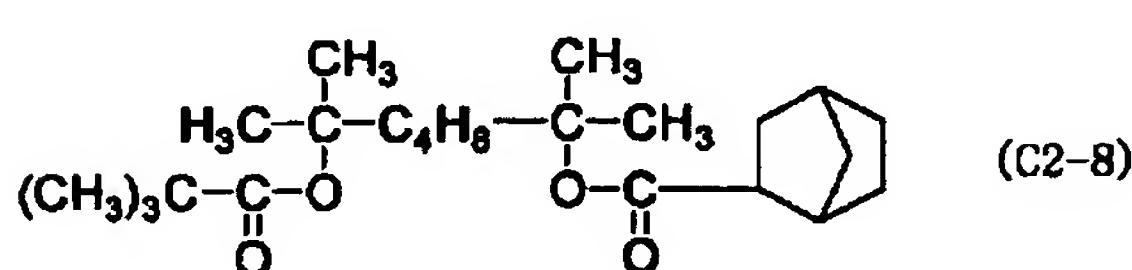
【化65】



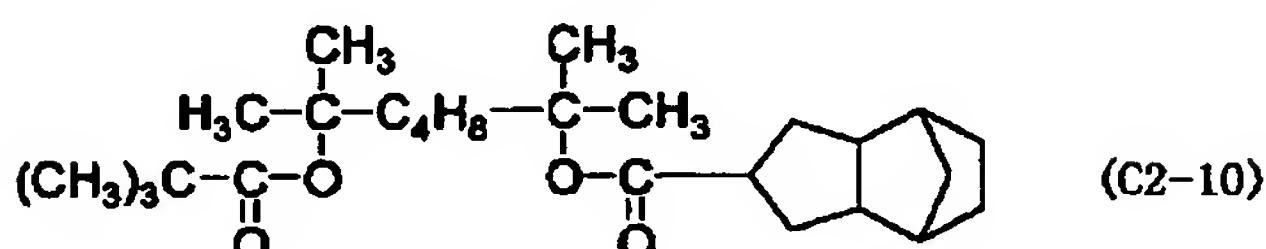
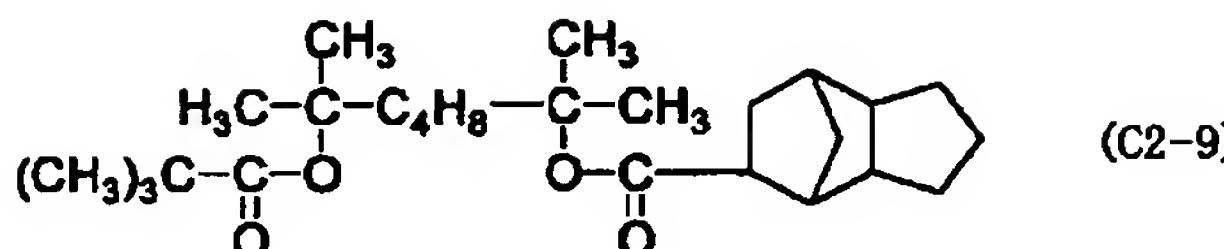
(C2-7)

【0145】

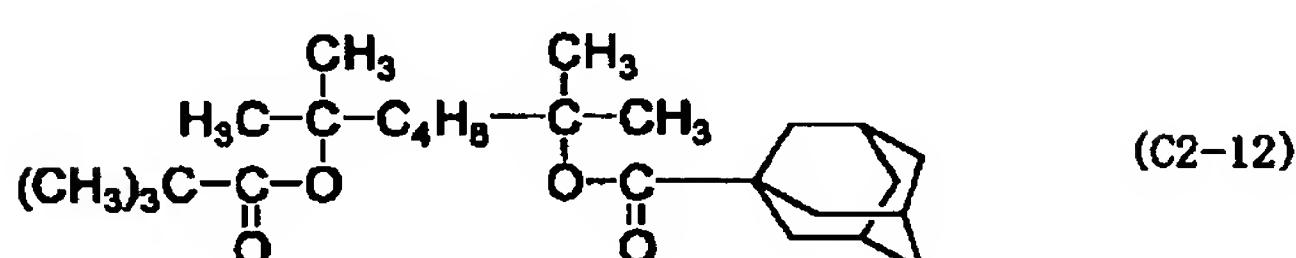
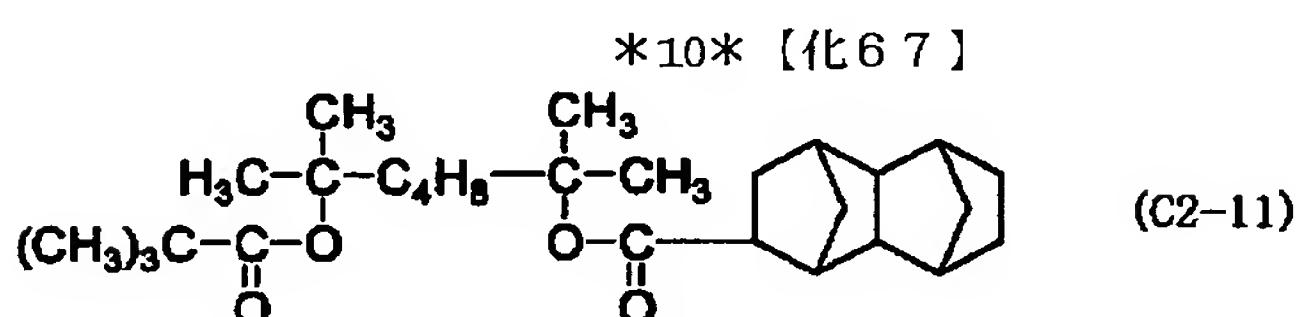
40 【化66】



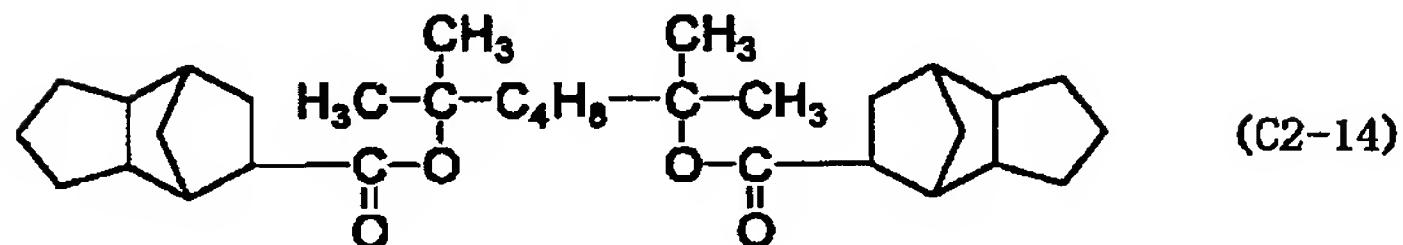
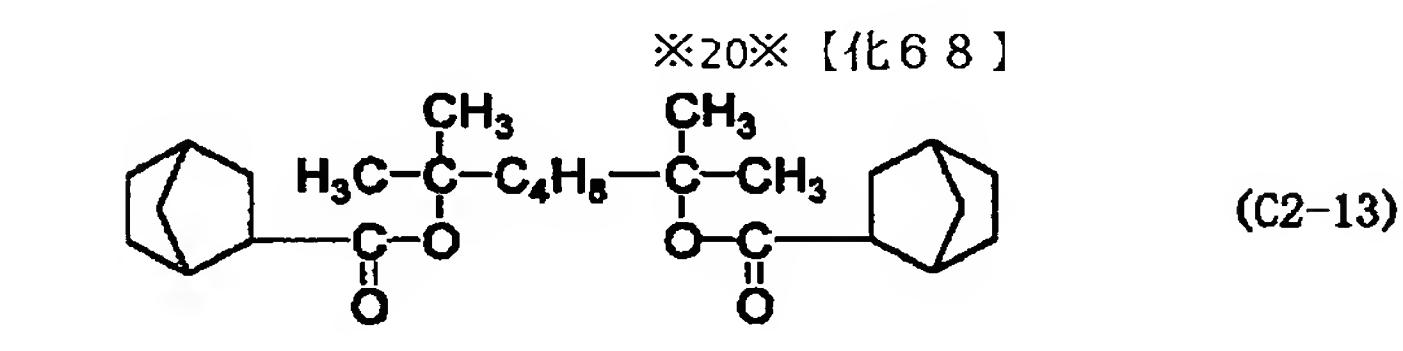
(C2-8)



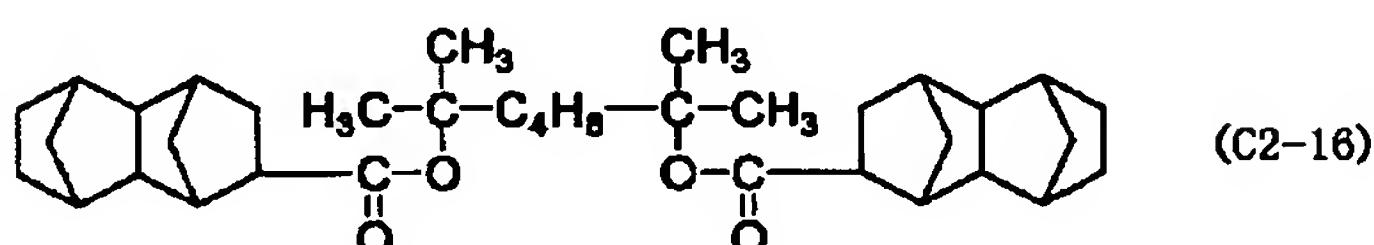
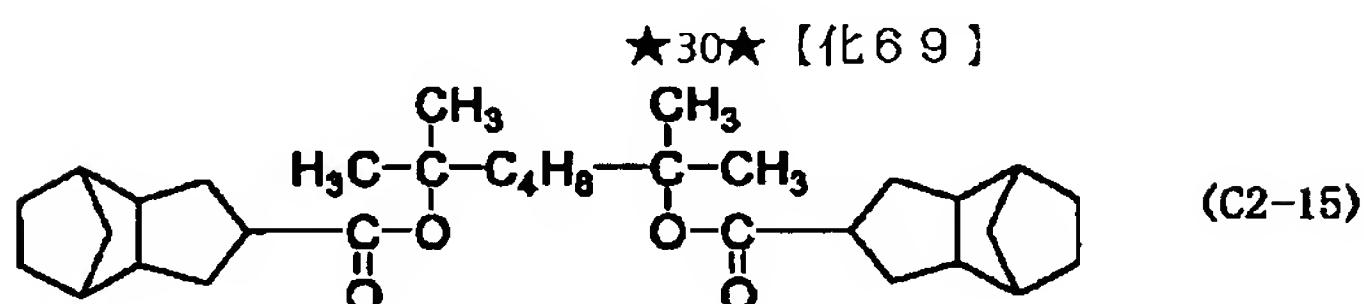
【0146】



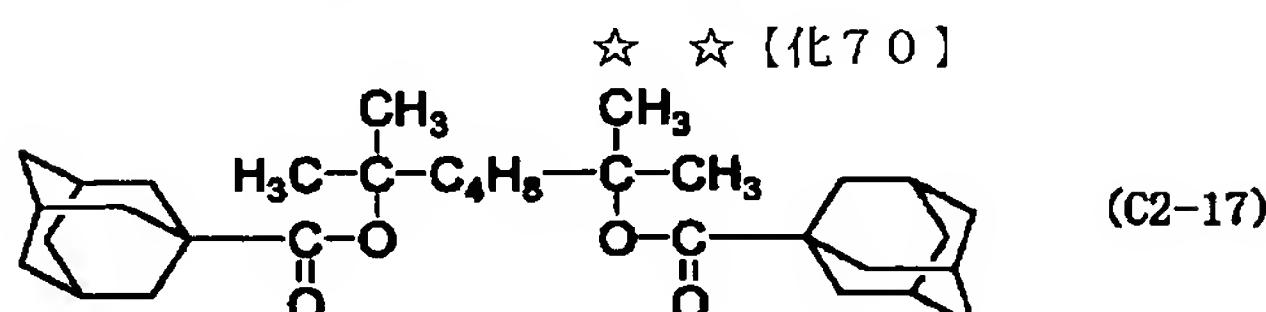
【0147】



【0148】



【0149】



【0150】これらの化合物(C2)のうち、特に、式(C2-7)、式(C2-13)または式(C2-17)で表される化合物等が好ましい。本発明において、化合物(C)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができます。化合物(C)の使用量は、樹脂(A)100重量部に対して、通常、30重量部以下、好ましくは

1~20重量部、特に好ましくは1~15重量部である。この場合、化合物(C)の使用量が30重量部を超えると、レジストとしての解像度や現像性が低下する傾向がある。

【0151】(D)成分

50 本発明における(D)成分は、前記一般式(7)で表さ

れる化合物（以下、「化合物（D）」という。）からなる。化合物（D）は、露光により酸発生剤から生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御し、非露光領域における好ましくない化学反応を抑制する作用を有する成分である。このような化合物（D）を配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が向上し、またレジストとしての解像度がさらに向上するとともに、露光から露光後の加熱処理までの引き置き時間（P E D）の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。

【0152】一般式（7）において、R¹⁸の炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、前記一般式（6-1）および一般式（6-2）におけるR¹⁷について例示した炭素数1～20の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基と同様のものを挙げることができる。これらのアルキル基のうち、メチル基、エチル基等が好ましい。

【0153】また、R¹⁸の炭素数6～20の1価の脂環族基としては、例えば、ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタンや、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類等に由来する脂環族環からなる基；これらの脂環族環からなる基を、例えば、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、i-ブロビル基、n-ブチル基、2-メチルブロビル基、1-メチルブロビル基、t-ブチル基等の炭素数1～4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基；これらのアルキル基で置換されていてもよい脂環族環からなる基を、ヒドロキシル基；カルボキシル基；オキソ基（即ち、=O基）；ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロビル基、2-ヒドロキシプロビル基、3-ヒドロキシプロビル基、1-ヒドロキシブチル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基、4-ヒドロキシブチル基等の炭素数1～4のヒドロキシアルキル基；メトキシ基、エトキシ基、n-ブロボキシ基、i-ブロボキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルブロボキシ基、1-メチルブロボキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1～4のアルコキシル基；シアノ基；シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロビル基、4-シアノブチル基等の炭素数2～5のシアノアルキル基等の1個以上あるいは1種以上で置換した基等挙げることができる。これらの脂環族基のうち、トリシクロデカン、アダマンタンやシクロヘキサンに由来する脂環族環からなる基等が好ましい。

【0154】また、2つのR¹⁸が相互に結合して形成した炭素数2～20の2価の基は、主鎖が炭素鎖からなる基でも、主鎖に異項原子（例えば、窒素原子、酸素原子、硫黄原子等）を有する基でもよく、また主鎖が炭素

鎖からなる2価の基は、例えば、直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキレン基や、ノルボルナン環等の有橋式炭素環を有する基、ベンゼン環、ナフタレン環等の芳香族環を有する基でもよい。また、前記2価の基に対する置換基としては、例えば、前記一般式（4）におけるR¹²のフェニル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基として例示したヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基等と同様のものを挙げることができる。

【0155】化合物（D）としては、例えば、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-オクチルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-ノニルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-デシルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン、N-t-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、N-t-ブトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N,N-ジ-t-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、N,N-ジ-t-ブトキシカルボニル-1-メチル-1-アダマンチルアミン、N-t-ブトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-メチルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール等を挙げることができる。

【0156】これらの化合物（D）のうち、N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン、N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール等が好ましい。本発明において、化合物（D）は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

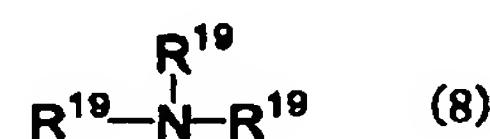
【0157】化合物（D）の使用量は、樹脂（A）100重量部に対して、通常、1重量部以下、好ましくは0.001～1重量部、特に好ましくは0.01～1重量部である。この場合、化合物（D）の使用量が1重量部を超えると、レジストとしての感度が却って低下する傾向がある。

【0158】添加剤

本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要に応じて、化合物（D）以外の酸拡散制御剤（以下、「他の酸拡散制御剤」という。）、化合物（C）以外の酸解離性基を有する脂環族添加剤（以下、「他の脂環族添加剤」という。）、界面活性剤、増感剤等の各種の添加剤を配合することができる。他の酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。このような含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式（8）

【0159】

【化71】



〔一般式(8)において、各R¹⁹は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置換もしくは非置換のアラルキル基を示す。〕

【0160】で表される化合物(以下、「含窒素化合物(イ)」といふ。)、同一分子内に窒素原子を2個有する化合物(以下、「含窒素化合物(ロ)」といふ。)、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体

(以下、これらをまとめて「含窒素化合物(ハ)」といふ。)、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素環化合物等を挙げることができる。

【0161】含窒素化合物(イ)としては、例えば、n-ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノ(シクロ)アルキルアミン類；ジ-n-ブチルアミン、ジ-n-ベンチルアミン、ジ-n-ヘキシルアミン、ジ-n-ヘプチルアミン、ジ-n-オクチルアミン、ジ-n-ノニルアミン、ジ-n-デシルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジ(シクロ)アルキルアミン類；トリエチルアミン、トリ-n-プロピルアミン、トリ-n-ブチルアミン、トリ-n-ベンチルアミン、トリ-n-ヘキシルアミン、トリ-n-ヘプチルアミン、トリ-n-オクチルアミン、トリ-n-ノニルアミン、トリ-n-デシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチルジシクロヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シクロ)アルキルアミン類；アニリン、N-メチルアニリン、N,N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニトロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類を挙げることができる。

【0162】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エチレンジアミン、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノジフェニルアミン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1,4-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン、1,3-ビス[1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル]ベンゼン、ビス(2-ジメチルアミノエチル)エーテル、ビス(2-ジエチルアミノエチル)エーテル等を挙げができる。含窒素化合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチルアミノエチ

ルアクリルアミドの重合体等を挙げることができる。

【0163】前記アミド基含有化合物としては、例えば、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N,N,N',N'-テトラ-t-ブトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-1,7-ジアミノヘプタン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-1,8-ジアミノオクタン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-1,9-ジアミノノナン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-1,10-ジアミノデカン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-1,12-ジアミノデカン、N-t-ブトキシカルボニル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン、N,N'-ジ-t-ブトキシカルボニル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド、ビロリドン、N-メチルビロリドン等を挙げることができる。

【0164】前記ウレア化合物としては、例えば、尿素、メチルウレア、1,1-ジメチルウレア、1,3-ジメチルウレア、1,1,3,3-テトラメチルウレア、1,3-ジフェニルウレア、トリ-n-ブチルチオウレア等を挙げることができる。前記含窒素複素環化合物としては、例えば、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、ベンズイミダゾール、2-フェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類；ビリジン、2-メチルビリジン、4-メチルビリジン、2-エチルビリジン、4-エチルビリジン、2-フェニルビリジン、4-フェニルビリジン、2-メチル-4-フェニルビリジン、ニコチン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキシキノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のビリジン類；ビペラジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ビペラジン等のビペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、ブリン、ピロリジン、ビペリジン、3-ビペリジノ-1,2-プロパンジオール、モルホリン、4-メチルモルホリン、1,4-ジメチルビペラジン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン等を挙げができる。これらの他の酸拡散制御剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0165】前記他の脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタンカルボン酸t-ブチル、1-アダマンタンカルボン酸t-ブトキシカルボニルメチル、1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチル、1-アダマンタン酢酸t-ブチル、1-アダマンタン酢酸t-ブトキシカルボニルメチル、1,3-アダマンタンジ酢酸ジ-t-ブチル等のアダマンタン誘導体類；デオキシコール酸t-ブチル、デオキシコール酸t-ブトキシカル

ボニルメチル、デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒドロビラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステル類；リトコール酸t-ブチル、リトコール酸t-ブトキシカルボニルボニルメチル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコール酸2-シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロビラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコール酸エステル類等を挙げることができる。これらの他の脂環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0166】また、前記界面活性剤は、塗布性、ストリエーション、現像性等を改良する作用を示す成分である。このような界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンn-オクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンn-ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下商品名で、KP341（信越化学工業（株）製）、ポリフローNo.75、同No.95（共栄社化学（株）製）、エフトップEF301、同EF303、同EF352（トーケムプロダクツ（株）製）、メガファックスF171、同F173（大日本インキ化学工業（株）製）、フロラードFC430、同FC431（住友スリーエム（株）製）、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-105、同SC-106（旭硝子（株）製）等を挙げることができる。これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。

【0167】また、前記増感剤は、放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤（B）に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を示すもので、感放射線性樹脂組成物のみかけの感度を向上させる効果を有する。このような増感剤としては、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ナフタレン類、ビアセチル、エオシン、ローズベンガル、ビレン類、アントラセン類、フェノチアジン類等を挙げることができる。これらの増感剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。また、染料あるいは顔料を配合することにより、露光部の潜像を可視化させて、露光時のハレーションの影響を緩和でき、接着助剤を配合することにより、基板との接着性を改善することができる。さらに、前記以外の添加剤としては、後述するアルカリ可溶性樹脂、酸解離性の保護基を有する低分子のアルカリ溶解性制御剤、ハレーション防止剤、保存安定化剤、消泡

剤等を挙げることができる。

【0168】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際して、全固体分濃度が、通常、5～50重量%、好ましくは10～25重量%となるように、溶剤に溶解したのち、例えば孔径0.2μm程度のフィルターでろ過することによって、組成物溶液として調製される。前記組成物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-ブタノン、2-ベンタノン、3-メチル-2-ブタノン、2-ヘキサン、4-メチル-2-ベンタノン、3-メチル-2-ベンタノン、3,3-ジメチル-2-ブタノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状もしくは分岐状のケトン類；シクロヘキサン、3-メチルシクロヘキサン、シクロヘキサノン、2-メチルシクロヘキサン、2,6-ジメチルシクロヘキサン、イソホロン等の環状のケトン類；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-n-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-i-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-n-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-i-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-sec-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-t-ブチルエーテルアセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類；2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシプロピオン酸n-ブロビル、2-ヒドロキシプロピオン酸i-ブロビル、2-ヒドロキシプロピオン酸n-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸i-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸t-ブチル等の2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類；3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、【0169】n-プロピルアルコール、i-ブロビルアルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコール、シクロヘキサンノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ-n-ブロビルエーテル、エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジ-n-ブロビルエーテル、ジエチレングリコールジ-n-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-n-ブロビルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン

グリコールモノ-*n*-プロピルエーテル、トルエン、キシレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メチル酪酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸-*n*-プロピル、酢酸-*n*-ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、ビルビン酸メチル、ビルビン酸エチル、N-メチルビロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ベンジルエチルエーテル、ジ-*n*-ヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、カブロン酸、カブリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、 γ -ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン等を挙げることができる。

【0170】これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができるが、就中、直鎖状もしくは分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロビレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオン酸アルキル類、 γ -ブチロラクトン等が好ましい。

【0171】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学增幅型レジストとして有用である。前記化学增幅型レジストにおいては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用によって、樹脂(A)中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基を生じ、その結果、レジストの露光部のアルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを形成する際には、組成物溶液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によって、例えば、シリコンウェハー、アルミニウムで被覆されたウェハー等の基板上に塗布することにより、レジスト被膜を形成し、場合により予め加熱処理(以下、「P B」という。)を行ったのち、所定のレジストパターンを形成するように該レジスト被膜に露光する。その際に使用される放射線としては、使用される酸発生剤(B)の種類に応じて、可視光線、紫外線、遠紫外線、X線、荷電粒子線等を適宜選定して使用されるが、KrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)あるいはF₂エキシマレーザー(波長157nm)に代表される遠紫外線が好ましく、特に波長200nm以下の放射線が好ましい。本発明においては、露光後に加熱処理(以下、「P E B」という。)を行うことが好ましい。このP E Bにより、酸解離性基の解離反応が円滑に進行する。P E Bの加熱

10

20

30

40

50

条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わらるが、通常、30~200°C、好ましくは50~170°Cである。

【0172】本発明においては、感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-188598号公報等に開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技術を併用することもできる。次いで、露光されたレジスト被膜をアルカリ現像液を用いて現像することにより、所定のレジストパターンを形成する。前記アルカリ現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、*n*-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ-*n*-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ビロール、ビペリジン、コリン、1, 8-ジアザビシクロ-[5. 4. 0]-7-ウンデセン、1, 5-ジアザビシクロ-[4. 3. 0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも1種を溶解したアルカリ性水溶液が好ましい。前記アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10重量%を超えると、非露光部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

【0173】また、前記アルカリ性水溶液には、例えば有機溶媒を添加することもできる。前記有機溶媒としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチル*i*-ブチルケトン、シクロヘキサン、シクロヘキサノン、3-メチルシクロヘキサン、2, 6-ジメチルシクロヘキサン等のケトン類；メチルアルコール、エチルアルコール、*n*-ブロピルアルコール、*i*-ブロピルアルコール、*n*-ブチルアルコール、 τ -ブチルアルコール、シクロヘキサン、シクロヘキサノール、1, 4-ヘキサンジオール、1, 4-ヘキサンジメチロール等のアルコール類；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類；酢酸エチル、酢酸-*n*-ブチル、酢酸*i*-アミル等のエステル類；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらの有機溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。有機溶媒の使用量は、アルカリ性水溶液に対して、100容量%以下が好ましい。この場合、有機溶媒の使用量が100容量%を超えると、現像性が低下して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。また、前記アルカリ性水溶液には、界面活性剤等を適量添加することもできる。なお、アルカリ現像液で現像した

のちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

【0174】

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。ここで、部は、特記しない限り重量基準である。実施例および比較例における各測定・評価は、下記の要領で行った。

Mw: 東ソー(株)製GPCカラム(G2000HXL2本、G3000HXL1本、G4000HXL1本)を用い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40°Cの分析条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルバーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した。

放射線透過率: 組成物溶液を石英ガラス上にスピンドルにより塗布し、90°Cに保持したホットプレート上で60秒間PBを行って形成した膜厚0.34μmのレジスト被膜について、波長193nmにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

【0175】感度: 基板として、表面に膜厚820ÅのARC25(ブルワー・サイエンス(Brewer Science)社製)膜を形成したシリコーンウェハー(ARC25)を用い、各組成物溶液を、基板上にスピンドルにより塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.34μmのレジスト被膜に、(株)ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(レンズ開口数0.55、露光波長193nm)により、マスクパターンを介して露光した。その後、表2に示す条件でPEBを行ったのち、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25°Cで60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅0.16μmのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)を1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

解像度: 最適露光量で解像される最小のレジストパターンの寸法を、解像度とした。

【0176】ドライエッティング耐性: 組成物溶液をシリコーンウェハー上にスピンドルにより塗布し、乾燥して形成した膜厚0.5μmのレジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッティング装置(Pinnacle8000)を用い、エッティングガスをCF₄とし、ガス流量75sccm、圧力2.5mTorr、出力2,500Wの条件でドライエッティングを行って、エッティング速度を測定し、クレゾールノボラック樹脂からなる被膜のエッティング速度に対する相対値により、相対エッティング速度を評価した。エッティング速度が小さいほど、ドライエッティング耐性に優れることを意味する。

パターン形状: 線幅0.16μmのライン・アンド・ス

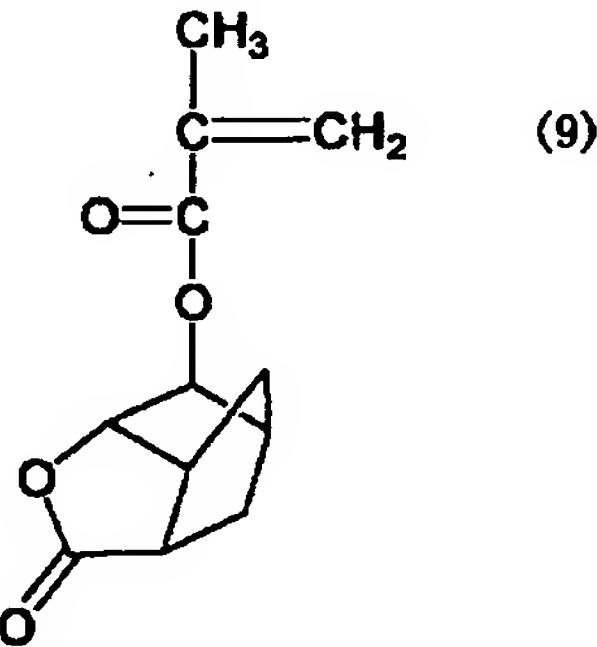
ベースパターン(1L1S)の方形状状断面の下辺寸法Lbと上辺寸法Laとを走査型電子顕微鏡により測定し、0.85≤La/Lb≤1を満足し、かつパターン形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が“良好”とした。

【0177】合成例1

5-(2-メチル-2-アダマンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン36.03g、無水マレイン酸12.42g、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート11.97g、下記式(9)で表されるメタクリル酸エステル(以下、「メタクリル酸エステル(9)」という。)22.53g、1-メチル-1-シクロベンチルメタクリレート17.05g、2-ブタノン200g、アゾビスイソ吉草酸メチル11.66gを、1,000ミリリットル三口フラスコに仕込み、30分間窒素バージしたのち、80°Cにて6時間重合した。重合終了後、反応溶液を30°C以下に冷却し、n-ヘプタン700gとイソプロパノール300gとの混合溶液中に投入して、析出した白色粉末を炉別した。その後、白色粉末をイソプロパノール300gと混合してスラリーとし攪拌して洗浄したのち、ろ別し、50°Cにて17時間乾燥して、白色粉末の樹脂を得た(71g、収率7.1重量%)。この樹脂はMwが12,500であり、5-(2-メチル-2-アダマンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、無水マレイン酸、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート、メタクリル酸エステル(9)および1-メチル-1-シクロベンチルメタクリレートの共重合モル比が25/25/10/20/20であった。この樹脂を樹脂(A-1)とする。

【0178】

【化72】



【0179】合成例2

仕込み单量体として、5-(1-メチル-1-シクロベンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン30.38g、無水マレイン酸13.52g、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート13.03g、メタクリル酸エステル(9)24.52g、1-メチル-1-シクロベンチルメタクリレート1

8. 56 g を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂を得た (69 g、収率69重量%)。この樹脂はM_wが12,500であり、5-(1-メチル-1-シクロベンチル)オキシカルボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、無水マレイン酸、3-ヒドロキシ-1-アダマンチルメタクリレート1、メタクリル酸エステル(9)および1-メチル-1-シクロベンチルメタクリレートの共重合モル比が25/25/10/20/20であった。この樹脂を樹脂(A-2)とする。

【0180】

【実施例】実施例1～3および比較例1

表1に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評価を行った。評価結果を表3に示す。表1における重合体(A-1)～(A-2)以外の成分は以下の通りである。

他の樹脂

a-1: メタクリル酸t-ブチル/メタクリル酸メチル/メタクリル酸共重合体(共重合モル比=40/40/20、M_w=20,000)

酸発生剤(B)

B-1: 1-[1-(4-n-ブトキシナフチル)]テト*

62
*ラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

B-2: N-ノナフルオロ-n-ブタンスルホニルオキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン-5,6-ジカルボイミド

B-3: トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

【0181】化合物(C)

C-1: アジピン酸ジ-n-ブチル(式(C1-32)参照)

10 照

C-2: 1,3-アダマンタンジカルボン酸ジ-t-ブチル(式(C1-8)参照)

【0182】化合物(D)

D-1: N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール

【0183】溶剤

E-1: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

E-2: 2-ヘプタノン

20 【0184】

【表1】

	樹脂(部)	酸発生剤(B)(部)	化合物(C)(部)	化合物(D)(部)	溶剤(部)
実施例1	A-1(100)	B-1(3)	—	D-1(0.25)	E-1(600)
実施例2	A-1(95)	B-1(2) B-2(2)	C-1(5)	D-1(0.15)	E-2(600)
実施例3	A-2(95)	B-1(2) B-2(3)	C-2(5)	D-1(0.12)	E-2(450)
比較例1	a-1(100)	B-3(3)	—	D-1(0.60)	E-1(600)

【0185】

※※【表2】

表2

	レジスト被膜の膜厚(μm)	基板の種類	P B		PEB	
			温度(℃)	時間(秒)	温度(℃)	時間(秒)
実施例1	0.34	ARC25	130	90	130	90
実施例2	0.34	ARC25	130	90	130	90
実施例3	0.34	ARC25	130	90	130	90
比較例1	0.34	ARC25	130	90	130	90

【0186】

【表3】

表 3

	放射線透過率 (193nm, %)	感 度 (J/m ²)	解像度 (μm)	ドライエッティング 耐性	パターン形状
実施例1	69	162	0.14	0.9	良好
実施例2	70	173	0.13	0.8	良好
実施例3	72	159	0.14	0.9	良好
比較例1	67	192	0.18	1.0	良好

【0187】

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、ArFエキシマレーザー（波長193nm）に代表される遠紫外線に感応する化学增幅型レジストとして、特に放射線に対する透明性が高く、高解像度であり、かつ優れた*

*ドライエッティング耐性を有するとともに、微細パターンにおける現像性が良好で、感度、パターン形状にも優れ、また基板に対する接着性およびパターンの裾形状も良好であり、今後ますます微細化が進行すると予想される集積回路素子の製造に極めて好適に使用できる。

フロントページの続き

(72)発明者 佐野 公康

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
エスアール株式会社内

(72)発明者 小林 英一

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
エスアール株式会社内

F ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA04 AA09

AB16 AC06 AC08 AD03 BE00

BE07 BE10 BG00 CB08 CB10

CB14 CB41 CC05 CC20 FA17

4J100 AK32Q AL08R AL08S AL08T

AR11P BA03R BA11S BA15P

BA40R BC03P BC03T BC04R

BC08R BC09P BC09R BC12R

BC53S CA03 CA04 CA05

CA06 JA37

THIS PAGE BLANK (USPTO)

